

**ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
К ЖУРНАЛУ «ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ»**

Том 23, 1989 год

- А бакарова Н. С., см. Степуренко А. А. 9, 1584
- А бакумов В. Н., Пахомов А. А., Шейнкман М. К., Яссиевич И. Н. Новый «электронный» механизм энергетической релаксации локальных колебаний сильно возбужденных дефектов. 12, 2232
- А басова А. З., Зайтов Ф. А., Любченко А. В., Султанмуратов С. Рекомбинационные процессы в радиационно облученных фоточувствительных структурах на основе селенида галлия. 1, 152
- А бдуллаев А. А., Гаджиев А. З. Влияние поверхностных явлений на фотоэлектрические свойства CdCr_2Se_4 . 5, 876
- А бдуллаев М. А., Гореленок А. Т., Кохановский С. И., Макушенко Ю. М., Пуляевский Д. В., Сейсян Р. П., Штенгель К. Э. Край оптического поглощения и деформации эпитаксиальных слоев $\text{In}_{0.33}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$. 2, 201
- А бдуллаев М. А., Кохановский С. И., Макушенко Ю. М., Сейсян Р. П. Край оптического поглощения «чистых» эпитаксиальных слоев InP . 7, 1156
- А бдуллаев М. А., Кохановский С. И., Кошуг О. С., Сейсян Р. П. «Тонкая» структура края поглощения кристаллов теллурида кадмия. 7, 1160
- А бдумананов У. Ж., см. Регель А. Р. 9, 1552
- А бдурахманов К. П., Закс М. Б., Касаткин В. В., Куликов Г. С., Першеев С. К., Ходжаев К. Х. Исследование диффузии меди в профилированном кремнии, полученном способом А. В. Степанова. 10, 1891
- А бдурахманов К. П., Ходжаев М. Д., Тешабаев А. Т., Умаров Т. А. Влияние никеля на кинетику образования и отжига термических центров в кремнии. 7, 1301
- А бдурахманов К. П., см. Лебедев А. А. 12, 2227
- А бдусаттаров А. Г., Емцев В. В., Машовец Т. В. Влияние параметров импульсного электронного облучения на эффективность образования дефектов в кремнии. 12, 2221
- А брамишвили В. Г., Комаров А. В., Рябченко С. М., Погорель В. И. Гигантские спиновые расщепления экситонных состояний в ван-Флекковском магнитосмешанном полупроводнике $\text{Zn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{Te}$. 3, 575
- А брамов В. В., Божко А. Д., Кульбачинский В. А., Чудинов С. М. Эффект локализации в инверсионном слое на поверхности кремния. 9, 1704
- А брамян Ю. А., Папазян К. З. Полевые фототранзисторы с $p-n$ -переходом на основе $\text{Pb}_{0.78}\text{Sn}_{0.22}\text{Te}$. 8, 1486
- А броян И. А., Алиев Б. З., Имамкулиев С. Д., Казьмин С. А., Кайданов В. И., Касаманлы Г. Д. Электрофизические свойства пленок PbTe , облученных ионами аргона. 2, 352
- А броян И. А., Беляков В. С., Крысов Г. А., Титов А. И. Ионно-стимулированное восстановление кристаллической структуры GaAs . 5, 892
- А веркиев Н. С., Белорусец Е. Д., Имамов Э. З., Ребане Ю. Т. Энергетический спектр многозарядных примесных центров в кубических полупроводниках. 7, 1193
- А веркиев Н. С., Гуткин А. А., Красикова О. Г., Осипов Е. Б., Рециков М. А. Влияние случайных полей на спектр ЭПР акцепторов MnGa в $p\text{-GaAs}$. 1, 73
- А веркиев Н. С., Гуткин А. А., Осипов Е. Б., Седов В. Е., Цацульников А. Ф. AgGa^+ — новый ян-теллеровский акцептор в GaAs . 11, 2072
- А враменко С. Ф., Киселев В. С., Махлин А. Н. Исследование диффузии свободных экситонов в 3C-SiC -светодиодах. 3, 521
- А врутин Е. А., Алексеев М. А., Кучинский В. И., Лазутка А. С. Поляризационные характеристики излучения РОС лазеров с деформированным активным слоем. 7, 1207
- А гекян В. Ф., Александров Б. Г., Степанов Ю. А. Спектральные и временные характеристики термически делокализованных экситонов в твердом растворе $\text{CdS}_{1-x}\text{Se}_x$. 11, 1951
- А гринская Н. В., Аркадьева Е. Н., Терентьев А. И. Влияние

- крупномасштабных флуктуаций потенциала на явления переноса в полупроводящих кристаллах CdTe<Cl>. 2, 231
- Агринская Н. В., Матвеев О. А., Терентьев А. И., Шашкова В. В. Неэквивалентные состояния примеси фосфора в кристаллах CdTe. 3, 439
- Адамия З. А., см. Аладашвили Д. И. 2, 213
- Адомайтис Э., Викторавичюс В., Галдикас А., Гребинский С., Захаров С. Кинетика фотопродвижности в легированном хромом CdIn₂S₄. 6, 1096
- Азимов Г. К., Зайнабидинов С., Назыров Д. Э. Диффузия скандия в кремнии. 3, 556
- Азимов Г. К., Зайнабидинов С. З., Козлов Ю. И. Диффузия ванадия в кремнии. 10, 1890
- Аитов Р. Д., Маслов А. И., Ржевкин К. С. СВЧ шум горячих электронов в GaAs при температурах кристалла 10—100 К. 9, 1640
- Айдаралиев М., Зотова Н. В., Карандашев С. А., Стусь Н. М. Температурная зависимость люминесценции арсенида индия и твердых растворов InAsSbP и InGaAs. 4, 592
- Айраксинен В.-М., см. Пихтин А. Н. 7, 1280
- Акимов Б. А., Вертецкий П. В., Зломанов В. П., Рябова Л. И., Тананаева О. И., Широкова Н. А. Осцилляции Шубникова—де-Гааза в PbTe(Cr). 2, 244
- Акимов Б. А., Никорич А. В., Рябова Л. И., Широкова Н. А. Переход металл—диэлектрик в твердых растворах Pb_{1-x}Mn_xTe(In). 6, 1019
- Акимов Б. А., Никорич А. В., Хохлов Д. Р., Чесноков С. Н. Проводимость сплавов Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te(In) при комбинированном воздействии электрического и магнитного полей. 4, 668
- Акимов Б. А., Хохлов Д. Р., Чесноков С. Н. Динамика движения рабочей вольтамперной характеристики сплавов Pb_{1-x}Sn_xTe<In>. 5, 899
- Акимченко И. П., Алещенко Ю. А., Дымова Н. Н., Заветова М., Краснопевцев В. В. Особенности разупорядочения GaAs при ионной имплантации азота. 6, 1093
- Аксенов И. А., Корзун Б. В., Маковецкая Л. А., Соболев Н. А., Жуков С. П. Энергетические уровни в CuInS₂, связанные с собственными дефектами. 9, 1696
- Аладашвили Д. И., Адамия З. А., Лавдовский К. Г., Левин Е. И., Шкловский Б. И. Эффект Френкеля—Пула в области прыжковой проводимости в слабо компенсированных полупроводниках. 2, 213
- Алекперов С. А., Кенгерли Д. Ф. 1/f-шум дисков Корбино из InSb в сильных магнитных полях. 12, 2138
- Александров Б. Г., см. Агекян В. Ф. 11, 1951
- Алексеев М. А., Карлик И. Я., Мирлин Д. Н., Сапег В. Ф. Спектроскопия горячей фотолуминесценции в полупроводниках (обзор). 5, 761
- Алексеев М. А., см. Аврутин Е. А. 7, 1207
- Алешин А. М., Задорожный Н. С., Коваленко В. Ф., Краснов В. А., Сахаров В. А., Сущко Б. И. Диффузионная длина в эпитаксиальном поликристаллическом кремнии, полученном вакуумным испарением. 6, 1116
- Алещенко Ю. А., см. Акимченко И. П. 6, 1093
- Алиев Б. З., см. Аброян И. А. 2, 352
- Алиев К. М., см. Стенуренко А. А. 9, 1584
- Алимичев В. И., Гуральник И. Р. Импеданс фотопроводника при параметрической неустойчивости пространственного заряда. 2, 372
- Аминов Т. Г., см. Балинас В. 10, 1859
- Анастасьева Н. А., Большеева Ю. Н., Освенский В. Б., Степанцова И. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. Влияние легирования индием на люминесценцию монокристаллов арсенида галлия. 7, 1259
- Анатычук Л. И., Булат В. И., Булат Л. П., Комолов Е. Н. Коэффициент полезного действия термоэлемента при больших тепловых потоках.* 7, 1320
- Анатычук Л. И., Булат Л. П., Комолов Е. Н. Об эффективности термоэлектрических материалов при больших тепловых потоках.* 7, 1321
- Андаспаева А. А., Баранов А. Н., Гребенщикова Е. А., Гусейнов А. А., Именков А. Н., Рогачев А. А., Филаретова Г. М., Яковлев Ю. П. Спонтанная электролюминесценция в гетеропереходах II типа на основе GaInAsSb/GaSb ($\lambda=2.5$ мкм, $T=300$ К). 8, 1373
- Андреев В. М., Воднев А. А., Ларионов В. Р., Пруцких Т. А., Румянцев В. Д., Расулов К. Я., Хвостиков В. П. Фотоэлектрические свойства AlGaAs—GaAs-гетероструктур с туннельно-тонким «широкозонным окном». 4, 597
- Андреев В. М., Еремин В. К., Строкан Н. Б. Кинетика тока, ограниченного объемным зарядом, в полупроводниковых n^+p-p^+ структурах. 3, 478
- Андреев В. М., Зимогорова Н. С., Карлина Л. Б., Никитин Л. П., Устинов В. М., Васильев А. М. Фотолуминесцентные свойства твердых растворов In_{0.53}Ga_{0.47}As, легированных рением. 4, 612
- Андрухив М. Г., Вирт И. С., Цюцюра Д. И., Шуптар Д. Д., Шкумбатьк П. С. Фотоэлектрические и шумовые свойства пластически деформированных монокристаллов Cd_xHg_{1-x}Te. 7, 1263
- Аникин М. М., Евстропов В. В., Попов И. В., Растегаев В. Н., Стрельчук А. М., Сыркин А. Л. Неклассический термоинжекцион-

* Статьи, отмеченные звездочкой, депонированы в ЦНИИ «Электроника».

- ный ток в карбид-кремниевых $p-n$ -структурах. 4, 647
- Аникин М. М., Евстропов В. В., Попов И. В., Стрельчук А. М., Сыркин А. Л. Разновидность неклассического термоинжекционного тока в карбид-кремниевых $p-n$ -структурах. 10, 1813
- Аношин Ю. А., Базин В. М., Даревский А. С. Определение рекомбинационных параметров тонкобазных фотоэлектрических преобразователей на основе анализа световой вольтамперной характеристики. 6, 937
- Антонова И. В., Васильев А. В., Панов В. И., Шаймеев С. С. Поведение примеси золота в кремнии при радиационно-термических воздействиях. 2, 253
- Антонова И. В., Васильев А. В., Панов В. И., Шаймеев С. С. Особенности отжига дивакансий в кремнии, содержащем разупорядоченные области. 6, 1076
- Антонова И. В., Васильев А. В., Панов В. И., Шаймеев С. С. Параметры распределения дивакансий в нейтронно-облученном кремнии. 8, 1519
- Антонова И. В., см. Шаймеев С. С. 8, 1367
- Апатская М. В., Сизов Ф. Ф., Тетеркин В. В., Ущанкина Н. Н. Электрофизические свойства сверхрешеток $PbTe-Pb_{1-x}Sn_xTe$. 7, 1203
- Аракелян В. С., Бархударян Г. Р. Исследование лазерной диффузии в n - и p -типа проводимости. 4, 640
- Арапов Ю. Г., см. Якунин М. В. 12, 2203
- Аркадьева Е. Н., см. Агринская Н. В. 2, 231
- Аронзон Б. А., Копылов А. В., Мейлихов Е. З. Высокочастотная проводимость $n-Cd_xHg_{1-x}Te$ вблизи перехода металл-диэлектрик. 3, 471
- Арсентьев Н. Н., см. Терехов В. А. 2, 268
- Артемьев В. А., Витовский Н. А., Михнович В. В. Скопления точечных дефектов и их влияние на рассеяние носителей заряда в полупроводниках. 8, 1395
- Арутюнян В. М., Варданян С. Х., Маргарян А. Л. Очувствленные полупроводников приповерхностным полем, возникающим при контакте с электродом. 11, 2062
- Арутюнян В. М., Димаксян М. Л., Элбакян В. Л., Григорян Г. Е. Рентгеночувствительность моноселенида галлия. 3, 505
- Арушанов Э. К., Кулюк Л. Л., Натсеров А. Н., Радаудан С. И., Шемякова Т. Д., Штанов А. А. Стационарная разрешенная во времени фотолюминесценция монокристаллов фосфида кадмия. 1, 58
- Арушанов Э. К., см. Лашкул А. В. 8, 1406
- Архипов В. И., Никитенко В. Р. Дисперсионный транспорт в материалах с немонотонным энергетическим распределением локализованных состояний. 6, 978
- Асеев А. Л., Федина Л. И. О механизме формирования скоплений междоузельных атомов в кремнии при высокотемпературной ионной имплантации. 1, 171
- Аскеров Б. М., Джафаров М. И. Диссипативные термо- и гальваномагнитные явления в полупроводниках в произвольных квантующих магнитных полях. 7, 1275
- Аскеров И. М., Асланов Г. К., Насрединов Ф. С., Тагиев Б. Г. Дефектные полупроводники Ga_2S_3 и Ga_2Se_3 , легированные железом. 6, 1083
- Аскеров И. М., Кобелев В. Ф., Мастеров В. Ф., Тагиев О. Б., Штельмах К. Ф., Лихолит Л. Ф. О состоянии примеси европия в дефектных соединениях $A_2^{III}B_3^{VI}$ по данным ЭПР и эффекта Мессбауэра. 7, 1307
- Аскеров И. М., Мастеров В. Ф., Романов В. В., Штельмах К. Ф. ЭПР и магнитная восприимчивость дефектных кристаллов $A_2^{III}B_3^{VI}$, легированных марганцем. 7, 1305
- Асланов Г. К., см. Аскеров И. М. 6, 1083
- Астахова Е. Ф., см. Омеляновская Н. М. 8, 1503
- Атабаев И. Г., Баграев Н. Т., Машков В. А., Саидов М. С., Сирошов У., Юсупов А. Реакции центров золота с отрицательной корреляционной энергией в твердых растворах $Si-Ge$. 3, 525
- Ахмедова Ф. И., см. Ибрагимова М. И. 7, 1249
- Бабаев А. А., Теруков Е. И., Жданович Н. С., Мусабеков Е. Фотолюминесценция в пленках $a-Si_{1-x}C_x$: Н и $\alpha-Si_{1-x}N_x$: Н. 4, 636
- Бабаходжаев У. С., см. Голикова О. А. 10, 1737
- Бабенцов В. Н., Булах В. М., Горбань С. И., Рашковецкий Л. В., Сальков Е. А. Тонкая структура излучения при рекомбинации на комплексных дефектах в теллуриде кадмия. 9, 1560
- Бабенцов В. Н., Горбань С. И., Сальков Е. А. Рассеяние поляритонов и локализация экситонов на флуктуациях состава $Zn_xCd_{1-x}Te$. 1, 174
- Бабий П. И., Гамерник Р. В., Гнатенко Ю. П., Крочук А. С. Проявление донорных свойств примеси скандия в кристаллах $CdTe$ и $ZnTe$. 4, 739
- Баграев Н. Т., Половцев И. С. Оптическая самокомпенсация донорных центров железа в кремнии. 6, 1098
- Баграев Н. Т., Половцев И. С. Реакции центров железа, индуцированные пиннингом уровня Ферми в кремнии p -типа. 9, 1643
- Баграев Н. Т., см. Атабаев И. Г. 3, 525
- Бадалян С. М. Рассеяние электронов двумерного газа Ферми на акустических фононах вблизи границы раздела упругих полупространств. 10, 1756
- Базин В. М., см. Аношин Ю. А. 6, 937
- Байдусь Н. В., см. Карпович И. А. 12, 2164

Байрамов Б. Х., Захаренков Л. Ф., Ильменков Г. В., Мастеров В. Ф., Топоров В. В. Влияние РЗЭ на свойства объемных монокристаллов InP. 8, 1496

Байрамов М. А., Веденеев А. С., Ждан А. Г. Динамика проявлений флукуационного потенциала и поверхностного рассеяния в кинетических характеристиках инверсионного Si—*n*-канала. 12, 2122

Байрамов М. А., Веденеев А. С., Ждан А. Г., Щамхалова Б. С. Поверхностное рассеяние носителей заряда в инверсионных *n*-каналах Si—МОП структур. 9, 1618

Баканас Р. К., Басс Ф. Г. Возбуждение продольных колебаний решетки доменами Ганна в периодически легированном образце. 7, 1243

Бакин Н. Н., Брудный В. Н., Пешев В. В., Смородинов С. В. Образование центров E10 ($E_c - 0.62$ эВ) в области пространственного заряда и нейтральном объеме *n*-InP при электронном и γ -облучениях. 5, 890

Бакиш И. С., Гринь В. Ф., Карачевцева Л. А., Кодалашвили М. З., Сальков Е. А., Хижняк Б. И. Влияние дефектов структуры на интенсивность 1/*f*-шума в *n*-Cd_{*x*}Hg_{1-*x*}Te. 3, 571

Балагуров Л. А., Карпова Н. Ю., Омельяновский Э. М., Сизов В. Е. Исследование спектров примесного поглощения *a*-Si_{1-*x*}C_{*x*}: H методом фотоакустической спектроскопии. 4, 673

Балинас В., Галдикас А., Кроткус А., Сталенис А., Аминов Т. Г. Пикосекундная фотопроводимость в CdCr₂Se₄. 10, 1859

Балтрамеюнас Р., Вайнерт Х., Геразимас Е., Куокштис Э., Ханнебергер Ф. Исследование оптического усиления в сверхрешетках GaAs—Al_{*x*}Ga_{1-*x*}As. 5, 792

Балтрамеюнас Р., Велецкас Д. Влияние амплитудной решетки на дифракционную эффективность динамических голограмм в кремнии. 3, 517

Балтрамеюнас Р., Велецкас Д., Скайстис Э. Влияние перезарядки мелких примесей на дефокусировку лазерного луча в кристаллах кремния. 7, 1214

Балтрамеюнас Р., Юршенас С., Жукаускас А., Куокштис Э., Латинис В. Кинетика возгорания люминесценции остывающей электроннодырочной плазмы в кристалле CdSe. 3, 535

Банкина В. Ф., см. Коржув М. А. 9, 1545

Банная В. Ф., Веселова Л. И., Гершензон Е. М. Особенности температурной зависимости холловской подвижности в легированных и некомпенсированных полупроводниках. 2, 338

Баранов А. Н., Воронина Т. И., Лагунова Т. С., Тимченко И. Н., Чугуева З. И., Шерстнев В. В., Яковлев Ю. П. Кинетика изменения концентрации структурных дефектов и их роль в рассеянии дырок в *p*-GaSb. 5, 780

Баранов А. Н., см. Андаснаева А. А. 8, 1373

Барановский С. Д., Гельмонт Б. Л., Голубев В. Г., Иванов-Омский В. И., Осутин А. В. Спектроскопические определение степени компенсации и концентрации примесей в высокоочистом GaAs. 8, 1434

Барановский С. Д., Шкловский Б. И. Две модели туннельной излучательной рекомбинации в неупорядоченных полупроводниках. 1, 146

Барановский С. Д., Шкловский Б. И. Температурная зависимость формы линии фототермической понижения примесей в слабо легированном слабо компенсированном полупроводнике. 1, 192

Баранский П. И., Городничий О. П., Шевченко Н. В., Боднарчук О. А. Поглощение света свободными носителями в узкозонных полупроводниках в области собственной проводимости.* 3, 579

Барнинова Э. Ю., Берман Л. С., Грехов И. В., Григорьева Г. М., Каган М. Б., Кушавили К. Ш. Исследование радиационных дефектов в *p*-кремнии с примесью лития.* 3, 582

Бархударян Г. Р., см. Аракелян В. С. 4, 640

Барышев Н. С., см. Беговатов В. Е. 11, 2074

Барышев Н. С., см. Ибрагимова М. И. 7, 1249

Басалаев Ю. М., см. Полюгалов Ю. И. 2, 279

Басс Ф. Г., см. Баканас Р. К. 7, 1243

Батырев В. А., Лукашевич П. Г. Влияние неоднородности распределения электронов и дырок на спектры излучения электронно-дырочной плазмы. 3, 550

Бахадырханов М. К., Парманкулов И. П. Неустойчивость тока в кремнии, компенсированном марганцем, связанным с рекомбинационными волнами. 9, 1646

Баханова Е. В., Васько Ф. Т. Увлечение дырок ИК излучением в относительно деформированном полупроводнике. 2, 274

Бахматюк Б. П., см. Григорчук И. И. 11, 2083

Беговатов В. Е., Барышев Н. С., Белый Н. Н., Брязкий М. Н., Горбатюк И. Н. Рекомбинационные процессы в *p*-Mn_{*x*}Hg_{1-*x*}Te с $x \approx 0.1$. 11, 2074

Бедный Б. И., Василевский М. И., Карпович И. А. Определение приповерхностного изгиба зон по кинетике барьерно-ловушечной фотоэдс. 2, 362

Бедный Б. И., см. Карпович И. А. 12, 2164

Безлюдный С. В., Карпов В. Г., Колесников Н. В., Якименко А. Н. Механизм генерации заряда в МДП структуре. 11, 2013

Безлюдный С. В., Колесников Н. В., Санин К. В., Суриков И. Н., Хансеваров Р. Ю., Якименко А. Н. Влияние γ -облучения на генерацию носителей заряда в МДП структурах на основе кремния. 10, 1888

- Безручко Б. П., Ерастова Е. Н. О возможности появления хаотических решений в модели узкозонного полупроводника в режиме ударной ионизации. 9, 1707
- Беклемышев В. И., Маслов А. П., Махонин И. И., Морозов А. Ф., Петров Ю. Н., Пустановой В. И. Релаксация фотопотенциала кремния в электролите. 11, 1943
- Белецкий Н. Н., Глухов О. В. Резонансное взаимодействие поверхностных поляритонов в плоском слое магнитоактивной полупроводниковой плазмы.* 7, 1319
- Белов Н. П., Прокопенко В. Т., Яськов А. Д. *k-p*-Параметры полупроводников, рассчитанные методом нелокального эмпирического псевдопотенциала. 11, 2093
- Белоконов С. А., см. Тетеркин В. В. 11, 2096
- Белокурова И. Н., Третьяк О. В., Шаховцова С. И., Шварц М. М., Шматов А. А. Емкостная спектроскопия глубоких уровней облученных твердых растворов германий—кремний. 10, 1869
- Белорусец Е. Д., см. Аверкиев Н. С. 7, 1193
- Белотелов С. В., см. Волков В. В. 8, 1400
- Белюсова Т. В., Неизвестный И. Г., Садофьев Ю. Г., Супрун С. П., Шерстякова В. Н., Шумский В. Н. Надбарьерный фототок в гетеропереходах *p-Ge/n-GaAs*. 11, 1955
- Белый Н. Н., см. Беговатов В. Е. 11, 2074
- Беляков В. С., см. Аброян И. А. 5, 892
- Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Макарова Т. Л., Румянцев Б. Л., Сресеи О. М., Ярошецкий И. Д. Влияние тонкого диэлектрического слоя на свойства ПЭВ на границе металл—полупроводник. 11, 1966
- Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Румянцев Б. Л., Сресеи О. М., Ярошецкий И. Д. Резонансные явления в структурах Шоттки при возбуждении «медленных» поверхностных электромагнитных волн. 3, 461
- Берегулин Е. В., Ярошецкий И. Д. Исследование релаксации энергии и захвата носителей заряда при фотоионизации примесных центров в *p-GaAs*. 6, 947
- Берман Л. В., Селиверстов А. И. Нейтрализация мелких примесей в кремнии светом из области фундаментального поглощения. 11, 1959
- Берман Л. С., Витовский Н. А., Воронков В. Б., Ломасов В. Н., Ременько А. Д., Ткаченко В. Н., Толстобров М. Г. Скорость введения и профиль концентрации А-центров в *n*-кремнии, облученном электронами с энергией вблизи порога дефектообразования. 4, 753
- Берман Л. С., Жепко В. А., Ломасов В. Н., Ткаченко В. Н. О природе радиационных дефектов в *n*-кремнии, облученном электронами с энергией вблизи порога дефектообразования. 12, 2129
- Берман Л. С., Клиnger П. М., Фистуль В. И. Определение параметров глубоких центров в перекомпенсированном полупроводнике методом температурной зависимости емкости и активной проводимости. 11, 1947
- Берман Л. С., см. Баринаева Э. Ю. 3, 582
- Берча А. И., Ермаков В. Н., Коломоец В. В., Назарчук П. Ф., Панасюк Л. И., Федосов А. В. Переходы от металлической проводимости к активационной в одноосно деформированном *n-Ge<Sb>*. 12, 2244
- Бирюлин Ю. Ф., Лагвилава Т. А., Мильвидский М. Г., Писаревская В. А., Соловьева Е. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. Об одной особенности донора—серы в GaP. 6, 1070
- Блохин И. К., Рахубовский А. А., Холоднов В. А. О частых свойствах изотипного контакта к высокоомному полупроводнику. 10, 1747
- Бобрикова О. В., Стась В. Ф., Герасименко Н. Н. Формирование профиля концентрации А-, Е-центров в ОПЗ кремниевых диодных структур. 10, 1838
- Бобылев Б. А., Косцов Э. Ш. Переходный ток в полупроводнике с барьерным контактом. 2, 224
- Бобылев Б. А., Овсюк В. Н., Севастьянов С. Б., Усик В. И. Емкостная модуляционная спектроскопия глубоких уровней в полупроводниках. 11, 1932
- Богачек Э. Н., Шкорбатов А. Г. Асимметрия тепловыделения и термоэдс в полупроводниковых микроконтактах. 12, 2234
- Богданова В. А., Люзе Л. Л., Семиколонова Н. А. Плазмонфононное возбуждение в арсениде галлия *n*-типа. 10, 1900
- Боднарук О. А., см. Баранский П. И. 3, 579
- Боднарук О. А., см. Глузман Н. Г. 6, 1032
- Божко А. Д., см. Абрамов В. В. 9, 1704
- Божко В. В., см. Волков В. В. 8, 1400
- Бойчук В. В., см. Григорчак И. И. 11, 2083
- Болотов В. В., Стучинский В. А. Влияние примеси бора на дрейф вакансий в областях пространственного заряда диодов Шоттки Al—*p*-Si. 7, 1142
- Большева Ю. Н., см. Анастасьева Н. А. 7, 1259
- Бончик А. Ю., Кияк С. Г., Огнева О. В., Поройков Ю. А., Памурская А. В., Равич В. Н. Лазерное твердофазное легирование фосфида индия. 10, 1893
- Бордовский Г. А., Каничев М. Р., Любин В. М. Емкостные характеристики барьера на границе Me—ХСП. 4, 616
- Борковская О. Ю., Горбач Т. Я., Дмитрук Н. Л., Мищук О. Н. Влияние микрорельефа поверхности на электрофизические характеристики контакта металл—полупроводник с барьером

- Шоттки. Фотозмиссионные характеристики. 12, 2113
- Борковская О. Ю., Дмитрук Н. Л., Литовченко В. Г., Мищук О. Н. К модели эффекта радиационно-стимулированного упорядочения в полупроводниках A_3B_5V . 2, 207
- Бородин О. М., см. Омеляновский Э. М. 1, 178
- Борщак В. А., Василевский Д. Л. Влияние хода уровня Ферми на расчет туннельно-рекомбинационного тока в гетеропереходе. 11, 2076
- Ботте В. А., Владимиров В. В., Горшков В. Н., Липтуга А. И., Малютенко В. К. Измерение концентрации плазмы при поперечном пробое в n -InSb. 7, 1303
- Бочков А. В., Гуревич Ю. Г., Машкевич О. Л. Явления переноса в полупроводниках при электрон-фононном увлечении. 10, 1752
- Брандт Н. Б., Гаськов А. М., Ладыгин Е. А., Скипетров Е. П., Хорош А. Г. О положении локальных уровней радиационных дефектов в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe$, облученных протонами. 11, 2034
- Браташевский Ю. А., см. Прозоровский В. Д. 5, 901
- Бродовой А. В., Лашкарев Г. В., Кучеренко И. В. Электронная структура собственных дефектов кристаллической решетки PbSe и $Pb_{1-x}Sn_xSe_x$. 8, 1506
- Бродовой А. В., см. Лашкарев Г. В. 5, 874
- Брудный В. Н., см. Бакин Н. Н. 5, 890
- Брук А. С., Говорков А. В., Мильвидский М. Г., Нулгер Т. А., Шленский А. А., Югова Т. Г. Влияние термообработки на люминесцентные свойства эпитаксиальных слоев GaAs, легированных Sn или Te. 3, 456
- Брунков П. Н., Конников С. Г., Папенцев М. И., Соболев М. М., Степанова М. Н. Бистабильные дефекты в GaAs, выращенном методом жидкофазной эпитаксии. 9, 1689
- Брунков П. Н., см. Соболев М. М. 6, 1058
- Брызкий М. Н., см. Беговатов В. Е. 11, 2074
- Бугай А. А., Зарицкий И. М., Лукин С. Н., Неймарк Е. И., Кабдин Н. Н. Частотная зависимость ширины линии ЭПР в аморфном кремнии в интервале $9\div 130$ ГГц. 5, 872
- Булат В. П., см. Анатычук Л. И. 7, 1320
- Булат Л. П., см. Анатычук Л. И. 7, 1320
- Булат Л. П., см. Анатычук Л. И. 7, 1321
- Булах В. М., см. Бабенцов В. Н. 9, 1560
- Бумялене С., Ласене Г., Пирагас К. Выпрямление переменного тока и генерация четных гармоник однородными полупроводниками с антисимметричной монотонной ВАХ. 8, 1479
- Буров П. А., см. Черкасов Ю. А. 9, 1572
- Бутусов Д. М., Гоцадзе Г. Г., Рыбкин Б. С. Эффективная модуляция излучения и N -образная ВАХ для фототока при электропоглощении света в двойной $P-i-N$ -гетероструктуре. 9, 1601
- Бушмарина Г. С., см. Коржув М. А. 9, 1545
- Буянов А. В., Пека Г. П., Ткаченко В. Н., Токалин О. А. Исследование градиентных гетероструктур электронно-зондовыми методами. 9, 1589
- Быковский В. А., Гирей В. А., Коршунов Ф. П., Утенко В. И. Механизмы излучательной рекомбинации в ядро легированном арсениде галлия. 1, 79
- Быковский В. А., Голубев П. Ф., Долгих Н. И. Излучательная рекомбинация в легированном глубокими примесями и облученном германии. 11, 1981
- Быковский В. А., Кольченко Т. И., Ломако В. М., Мороз С. Е. Свойства эпитаксиальных слоев GaAs, выращенных на германиевых подложках. 1, 166
- Быковский В. А., Утенко В. И. Люминесценции арсенида галлия с участием пар атомов переходных металлов и мелких примесей. 10, 1767
- Быковский В. Ю., Вовченко В. И., Дмитрук Н. Л. Изучение локальных центров в p -GaAs, легированном медью, методами нестационарной спектроскопии глубоких уровней и фотолюминесценции. 4, 729
- Вавилов В. С., см. Казарин С. А. 1, 156
- Вагидов Н. З., Грибников З. С., Иващенко В. М. Дрейфовая скорость горячих электронов в обогащенных слоях при неемпературном характере их распределения по энергии. 2, 304
- Вайнерт Х., см. Балтрамеюнас Р. 5, 792
- Вакаров Б. С., Вакарова И. С., Корляков А. Б., Кравченко С. Н., Петухов А. Г. Токовая неустойчивость, обусловленная фазовым переходом полупроводник-металл в квазидомерных структурах. 7, 1182
- Вакарова И. С., см. Вакаров Б. С. 7, 1182
- Вардаян С. Х., см. Арутюнян В. М. 11, 2062
- Вартамян А. Л., Киракосян А. А. Влияние неоднородности упругой среды на фононный механизм релаксации двумерных носителей заряда. 10, 1851
- Васецкий В. М., Гайдар А. В., Порошин В. Н., Саркисян Э. С. Фотопроводимость p -Ge при низких температурах, возбуждаемая излучением импульсного CO_2 -лазера. 8, 1508
- Васильевский Д. Л., см. Борщак В. А. 11, 2076
- Василевский М. И., см. Бедный Б. И. 2, 362
- Васильев А. В., см. Антонова И. В. 2, 253
- Васильев А. В., см. Антонова И. В. 6, 1076
- Васильев А. В., см. Антонова И. В. 8, 1519
- Васильев А. М., Копьев П. С., Надточий М. Ю., Устинов В. М. Переходы с участием размерно-квантованных подзон в спектре фотолюминесценции δ -легированного GaAs. 12, 2133
- Васильев А. М., см. Андреев В. М. 4, 612

- Васильев А. Н., Сабаликов В. А. Деформация поверхности полупроводника при локальном освещении. 1, 33
- Васильев А. Э., Ильин Н. П., Магстеров В. Ф. Спин-поляризованный расчет электронной структуры примесей переходных элементов в полупроводниках. Хром в арсениде и фосфиде галлия. 5, 804
- Васильев А. Э., Касаткин В. А., Савельев В. П. Квантовый выход люминесценции иттербия в фосфиде индия. 11, 2069
- Васильев В. А., см. Регель А. Р. 9, 1552
- Васильев О. Н., см. Гайдуков Ю. П. 11, 2098
- Васин А. С., Окулич В. И., Пантелеев В. А. Аномально-ускоренная диффузия фосфора из ионно-имплантированного слоя кремния под давлением. 3, 483
- Васьюк Ф. Т., см. Баханова Е. В. 2, 274
- Ващенко В. А., Кернер Б. С., Осипов В. В., Синкевич В. Ф. Расслоение инжектированной электронно-дырочной плазмы высокой плотности в пленках арсенида галлия. 8, 1378
- Ващенко В. А., Синкевич В. Ф. Управляемый быстродействующий переключатель на основе тонких пленок арсенида галлия. 10, 1902
- Веденев А. С., см. Байрамов М. А. 9, 1618
- Веденев А. С., см. Байрамов М. А. 12, 2122
- Вейс А. Н., Крупичка Р. Ю. Примесные состояния таллия в сульфиде свинца по данным ИК поглощения. 1, 185
- Вейс А. Н., Прокофьева Л. В. Примесь индия в селениде свинца — центр с отрицательной корреляционной энергией. 7, 1230
- Велецкас Д., см. Балтрамеюнас Р. 3, 517
- Велецкас Д., см. Балтрамеюнас Р. 7, 1214
- Велиев З. А. Коэффициент захвата дырок на плотных дислокационных рядах в полупроводниках при наличии квантующего магнитного поля. 8, 1524
- Вертелецкий П. В., см. Акимов В. А. 2, 244
- Вертелецкий П. В., см. Лашкарев Г. В. 5, 874
- Веселова Л. И., см. Бавная В. Ф. 2, 338
- Викторавичус В., см. Адомайтис Э. 6, 1096
- Викунин И. М., Ирхав И., Коробицын Б. В. Перестройка спектра излучения светодиода магнитным полем. 6, 1006
- Винецкий В. Л., Кудыкин Т. А. Три световые волны в области экситонного резонанса в кристаллах CdS. 10, 1910
- Виноградова Г. И., Гогаладзе Д. Т., Долгинов А. М., Малькова Н. В., Мильвидский М. Г., Соловьева Е. В. Об аномалиях электрофизических свойств эпитаксиальных слоев $\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$ и их природе. 7, 1177
- Виноградова Г. И., Гогаладзе Д. Т., Лошинский А. М., Соловьева Е. В., Долгинов Л. М. Влияние легирования расплава-раствора гадолинием и алюминием на электрические и люминесцентные свойства эпитаксиальных слоев GaSb. 9, 1651
- Винокуров Д. А., см. Конников С. Г. 8, 1416
- Винославский М. Н., см. Добровольский В. Н. 3, 416
- Вирт И. С., Любченко А. В., Мозоль П. Е., Гнатюк В. А. Особенности электрофизических и фотоэлектрических свойств монокристаллов $\text{Cd}_{x}\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ подвергнутых лазерному облучению. 8, 1386
- Вирт И. С., см. Андрухив М. Г. 7, 1263
- Витман Р. Ф., Витовский Н. А., Лебедев А. А., Машовец Т. В., Налбандян Л. В. Исследование скоплений компенсирующих центров в *n*-Si. 11, 2066
- Витман Р. Ф., Гусева Н. Б., Лебедев А. А., Таптыгов Э. С. Влияние кислорода на образование акцепторных уровней никеля в *n*-Si. 5, 919
- Витман Р. Ф., см. Лебедев А. А. 12, 2227
- Витовский Н. А., Емцев В. В., Машовец Т. В., Михнович В. В. Влияние упругих напряжений, создаваемых компонентами пар Френкеля, на энергетический спектр дефектов в полупроводниках IV группы. 1, 184
- Витовский Н. А., Емцев В. В., Машовец Т. В., Михнович В. В., Полоскин Д. С. Эффективность образования точечных дефектов в *n*- и *p*-Ge в условиях облучения при 77 и 300 К. 3, 425
- Витовский Н. А., Машовец Т. В., Налбандян Л. В. Скопления атомов меди в германии. 5, 911
- Витовский Н. А., см. Артемьев В. А. 8, 1395
- Витовский Н. А., см. Берман Л. С. 4, 753
- Витовский Н. А., см. Витман Р. Ф. 11, 2066
- Владимиров В. В., Каплан Б. И., Коллюх А. Г., Малютенко В. К. Отрицательная фотопроводимость на пороге возбуждения осциллятора. 6, 1104
- Владимиров В. В., Каплан Б. И., Коллюх А. Г., Малютенко В. К. Винтовая неустойчивость в Ge в условиях эксклюзии носителей заряда. 6, 1106
- Владимиров В. В., см. Ботте В. А. 7, 1303
- Вовненко В. И., см. Быковский В. Ю. 4, 729
- Воднев А. А., см. Андреев В. М. 4, 597
- Воеводин Е. И., Гершензон Е. М., Гольцман Г. Н., Птициан Н. Г. Энергетический спектр мелких акцепторов в сильно одноосно деформированном Ge. 8, 1356
- Воеводова А. В., Коршунов Ф. П., Соболев Н. А., Стук А. А. О влиянии ядерного легирования на радиационное дефектообразование в Si<Ge>. 7, 1173
- Волков А. С., Липко А. Л., Меретлиев Ш. М., Царенков Б. В. Спиновое эхо в системе свободных электронов полупроводника. 12, 2179

- Волков В. В., Падалко А. Г., Белотелов С. В., Божко В. В., Лазарев В. Б. Глубокие центры в монокристаллах и тонких слоях антимонида индия. 8, 1400
- Вольф Б. Е., см. Степанов Н. П. 7, 1312
- Воробьева В. В., Егорова М. В., Крещук А. М., Новиков С. В., Савельев И. Г. Легирование слоев $\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$ самарием. 9, 1699
- Воронин С. Т., Кравченко А. Ф., Шерстяков А. П., Горбушов К. В. Фотоэлектрические свойства эпитаксиальных арсенид-галлиевых p^+-n^- структур. 5, 787
- Воронина Т. И., см. Баранов А. Н. 5, 780
- Воронков В. Б., см. Берман Л. С. 4, 753
- Воронков В. П., Вяткин А. П., Иванов Б. В., Кулешов С. М., Рухадзе З. А. Вольтамперные характеристики контактов $\text{Pd}-\text{GaAs}$, подвергнутых лазерному отжигу. 3, 562
- Вьюрков В. В., Федирко В. А. Возможные квантовые особенности одномерного баллистического транспорта в полупроводниковых структурах. 9, 1713
- Вывченко О. Ф., Истратов А. А., Хлебков А. Г. Метастабильность дефектов, связанных с дислокациями в сульфиде кадмия. 8, 1521
- Выговская Е. А., см. Галаев А. А. 5, 916
- Выжигин Ю. В., Елисеев В. В., Костылев В. А., Ликунова В. М., Максимова С. А., Соболев Н. А. Изменение спектра глубоких уровней в кремниевых $p-n$ -переходах под влиянием собственных точечных дефектов.* 3, 581
- Выжигин Ю. В., Земан Я., Костылев В. А., Соболев Н. А., Шмид В. Уровни дефектов термообработки в кремнии под гидростатическим давлением. 4, 719
- Вяткин А. П., см. Воронков В. П. 3, 562
- Гавалешко Н. Н., Кривень С. И., Мазур Ю. И., Паранчич С. Ю., Сизов Ф. Ф. Электрические и оптические свойства полумангнитных твердых растворов $\text{Hg}_{1-x-y}\text{Cd}_x\text{Mn}_y\text{Se}$. 6, 943
- Гавалешко Н. П., см. Германенко А. В. 1, 117
- Гавалешко Н. П., см. Крылов К. Р. 3, 429
- Гаджиев А. З., см. Абдуллаев А. А. 5, 876
- Гайдар А. В., см. Васецкий В. М. 9, 1508
- Гайдуков Ю. П., Гаськов А. М., Малинский И. М., Никифоров В. Н., Расильева О. Н. Напряжения несоответствия в гетероструктуре $\text{Pb}_{0.93}\text{Sn}_{0.07}\text{Se}-\text{PbS}_{0.95}\text{Se}_{0.05}$. 11, 2098
- Галаев А. А., Выговская Е. А., Малинович М. Д. Влияние электронного облучения на характер низкотемпературной проводимости и емкости в кремниевых МДП структурах. 5, 916
- Галдикас А., см. Адомайтис Э. 6, 1096
- Галдикас А., см. Балинас В. 10, 1859
- Гамерник Р. В., см. Бабий П. П. 4, 739
- Гасан-заде С. Г., Жадько И. П., Зинченко Э. А., Романов В. А., Сальков Е. А., Шепельский Г. А. Влияние пластической деформации на фотомагнитный эффект и фотопроводимость в кристаллах $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$. 1, 85
- Гасанова А. Т., Исмаилов И. А., Мамедов Ш. Ф., Мехтиев А. Ш., Тагиев А. Г. Длина когерентности в полупроводниковой области контакта сверхпроводник—полупроводник с учетом непараболичности зоны. 2, 236
- Гаськов А. М., см. Брандт Н. Б. 11, 2034
- Гаськов А. М., см. Гайдуков Ю. П. 11, 2098
- Гашимзаде Н. Ф., Ивченко Е. Л., Кособукин В. А. Локализованные электронные состояния на дефектах полупроводниковой сверхрешетки. 5, 839
- Гейзер С. В., см. Мусатов А. Л. 11, 2056
- Гельмонт Б. Л., Голубев В. Г., Иванов-Омский В. И., Кропотов Г. И. Магнитоспектроскопия литийсодержащих доноров в германии. 10, 1874
- Гельмонт Б. Л., Голубев В. Г., Иванов-Омский В. И., Кропотов Г. И., Халлер Ю. Э. Магнитоспектроскопия комплекса $D(H, O)$ в германии. 8, 1440
- Гельмонт Б. Л., см. Барановский С. Д. 8, 1434
- Гельфанд Р. Б., Мудрый А. В., Пущкарчук А. Л., Ульяшин А. Г. Комплексообразование водорода с акцепторными и донорными примесями в кремнии. 8, 1448
- Генкин Г. М., Окомельков А. В. Горячие носители в узкощелевых полупроводниках в сильном электрическом поле. 4, 630
- Георгицэ Е. И., Постолаки И. Т., Смирнов В. А., Унтила П. Г. Фотолуминесценция $p\text{-InAs}\langle\text{Mn}\rangle$. 4, 745
- Геразимас Е., см. Балтрамеюнас Р. 5, 792
- Герасименко Н. Н., см. Бобрикова О. В. 10, 1838
- Германенко А. В., Миньков Г. М., Румянцев Е. Л., Рут О. Э., Гавалешко Н. П., Фрасуняк В. М. Влияние одноосной деформации на энергетический спектр и гальваномагнитные явления в бесщелевом $p\text{-HgMnTe}$. 1, 117
- Германенко А. В., Миньков Г. М., Румянцев Е. Л., Рут О. Э., Инишева О. В. Кинетические явления в одноосно деформированном $p\text{-Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ с $\epsilon_g > 0$. 5, 796
- Германенко А. В., Миньков Г. М., Румянцев Е. Л., Рут О. Э. Одноосно деформированный $p\text{-HgMnTe}$ с $\epsilon_g > 0$: гальваномагнитные эффекты, энергетический спектр. 12, 2190
- Гермогенов В. П., Отман Я. И., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. Ширина запрещенной зоны в твердом растворе $\text{GaSb}_{1-x}\text{Bi}_x$. 8, 1517
- Герчиков Л. Г., Субашиев А. В. Немонотонная зависимость ширины за-

- прецессионной зоны в пленке бесщелевого полупроводника. 12, 2210
- Гершензон Е. М., см. Банная В. Ф. 2, 338
- Гершензон Е. М., см. Воеводин Е. И. 8, 1356
- Гинзбург Л. П. Проводящая зона в условиях структурного беспорядка. 5, 813
- Гинзбург Л. П. Локализованные состояния в условиях структурного беспорядка. 9, 1629
- Гиппиус А. А., см. Казарян С. А. 1, 156
- Гирей В. А., см. Быковский В. А. 1, 79
- Гирка А. И., Клопиков Е. Б., Скуратов В. А., Шишкин А. В. Исследование методом аннигиляции позитронов дефектов в монокристаллах кремния, облученных ионами ксенона. 2, 328
- Гирка А. И., Кулешин В. А., Мокрушин А. Д., Мохов Е. Н., Свирида С. В., Шишкин А. В. Позитронная диагностика дефектов в карбиде кремния, облученном нейтронами. 7, 1270
- Гирка А. И., Кулешин В. А., Мокрушин А. Д., Мохов Е. Н., Свирида С. В., Шишкин А. В. Позитронная диагностика вакансионных дефектов в облученном электронами карбиде кремния. 12, 2159
- Гифейсман Ш. Н., см. Перлин Ю. Е. 4, 734
- Глазов В. М., Ким С. Г., Нуров К. Б. Исследование температурной зависимости скорости звука и сжимаемости в расплавленном кремнии. 10, 1834
- Глазов В. М., Ким С. Г., Сулейменов Т. Исследование поглощения ультразвука в расплавах антимолибидов галлия и индия. 1, 187
- Глазов В. М., Ким С. Г., Сулейменов Т. Распределение звука в расплавах селена и теллура. 8, 1469
- Глазов В. М., см. Регель А. Р. 7, 1129
- Глинчук К. Д., Заяц Н. С., Прохорович А. В. Влияние облучения протонами на люминесценцию арсенида галлия. 4, 657
- Глузман Н. Г., Леринман Н. К., Сабирзянова Л. Д., Боднарчук О. А., Горбатюк И. Н., Раренко И. М. Гальваномагнитные явления в кристаллах $n\text{-Hg}_{1-x}y\text{-Cd}_x\text{Mn}_y\text{Te}$ и $n\text{-Hg}_{1-y}\text{Mn}_y\text{Te}$ с $\epsilon_y > 0$. 6, 1032
- Глузов О. В., см. Белецкий Н. Н. 7, 1319
- Гнатенко Ю. П., см. Бабий П. И. 4, 739
- Гнатюк В. А., см. Вирт И. С. 8, 1386
- Говорков А. В., см. Брук А. С. 3, 456
- Гоголадзе Д. Т., см. Виноградова Г. И. 7, 1177
- Гоголадзе Д. Т., см. Виноградова Г. И. 9, 1651
- Голоикова О. А., Грехов А. М., Сальков Т. Е. Влияние трехцентровых связей на электронные свойства аморфного гидрированного кремния. 11, 2060
- Голоикова О. А., Домашевская Э. П., Казанин М. М., Кудоярова В. Х., Мездрогина М. М., Сорокина К. Л., Терехов В. А., Тростянский С. Н. Структурная сетка, уровень Ферми и плотность состояний аморфного кремния. 3, 450
- Голоикова О. А., Казанин М. М., Кудоярова В. Х., Мездрогина М. М., Сорокина К. Л., Бабаходжаев У. С. Эффект псевдоделирования аморфного кремния. 10, 1737
- Голубев В. Г., см. Барановский С. Д. 8, 1434
- Голубев В. Г., см. Гельмонт Б. Л. 8, 1440
- Голубев В. Г., см. Гельмонт Б. Л. 10, 1874
- Голубев Н. Ф., см. Быковский В. А. 11, 1981
- Гольдгур Е. Б., Рабинович Р. И. Влияние заряженных центров на захват медленных электронов нейтральными примесями в полупроводниках. 9, 1674
- Гольцман Г. Н., см. Воеводин Е. И. 8, 1356
- Горбань С. И., см. Бабенцов В. Н. 1, 174
- Горбань С. И., см. Бабенцов В. Н. 9, 1560
- Горбатюк И. Н., см. Беговатов В. Е. 11, 2074
- Горбатюк И. Н., см. Глузман Н. Г. 6, 1032
- Горбач Т. Я., см. Борковская О. Ю. 2113
- Горбунов М. В., Каминский А. С. Экситонная люминесценция кремния, легированного фосфором и галлием в концентрациях $5 \cdot 10^{16} - 3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. 2, 359
- Горбушов К. В., см. Воронин С. Т. 5, 787
- Гордеев В. А., Гудцев Г. Л., Мякенькая Г. С. О конфигурации «аномального» мунония в кристаллической решетке кремния. 3, 493
- Горев Н. Б., Костылев С. А., Макарова Т. В., Прохоров Е. Ф., Уколов А. Т. Немонотонность вольтамперной зависимости тонкопленочных полупроводниковых структур с барьером Шоттки. 2, 357
- Гореленок А. Т., см. Абдуллаев М. А. 2, 201
- Городецкий С. М., Литовский М. А. Способ определения времени жизни неосновных носителей в полупроводниках.* 3, 580
- Городилов Н. А., Доманская Л. И., Нейфельд Э. А., Шелушина Н. Г. Термоэдс р-HgMnTe в магнитном поле. 2, 316
- Городниченко О. К., Коваленко В. Ф. Высокотемпературная пластическая деформация и электрофизические свойства эпитаксиальных структур арсенида галлия. 12, 2214
- Городничий О. П., см. Баранский П. И. 3, 579
- Горшков В. Н., см. Ботте В. А. 7, 1303
- Горя О. С., Ковалев Л. Е., Коротков В. А., Маликова Л. В., Сямашкевич А. В. Спектральная память фотопроводимости высокоомного ZnSe. 11, 2090
- Горячев Д. Н., Рудь Ю. В., Тайров М. А. Поляризационная фоточувствительность барьеров электролит-CdGeF₂. 2, 312
- Горячев Д. Н., см. Беляков Л. В. 11, 1966

- Горячев Д. Н., см. Беляков Л. В. 3, 461
- Гоцадзе Г. Г., см. Бутусов Д. М. 9, 1601
- Грабов В. М., см. Степанов Н. П. 7, 1312
- Гребенщикова Е. А., см. Андаспаева А. А. 8, 1373
- Гребинский С., см. Адомайтис Э. 6, 1096
- Гредескул Т. С. Линейная по току энергетическая неоднородность квази-частиц в полупроводниковых слоях. 3, 568
- Гредескул Т. С., Гуревич Ю. Г. Новый гальванотермический эффект, обусловленный электрон-фононным увлечением. 4, 717
- Гредескул Т. С., Гуревич Ю. Г., Машкевич О. Л. Ток через полупроводниковую пластину с неравновесными фононами. 5, 905
- Гредескул Т. С., Гуревич Ю. Г., Машкевич О. Л. Разогрев носителей тока и фононов постоянным электрическим полем. 10, 1895
- Грессеров Б. Н., Мнацаканов Т. Т. О соотношении подвижностей носителей заряда в полупроводниках n - и p -типа. 9, 1658
- Грехов А. М., Кустов В. Е., Трипачко Н. А., Шаховцов В. И. Кластерный расчет деформационных зарядов дефектов в кремнии. 4, 746
- Грехов А. М., см. Голиков О. А. 11, 2060
- Грехов И. В., см. Баринаова Э. Ю. 3, 582
- Гречко В. А., см. Малик А. И. 11, 2049
- Грибников Э. С., Райчев О. Э. ГХ-перенос в реальном пространстве: вклад рассеяния на междолинных фононах. 12, 2171
- Грибников З. С., см. Вагидов Н. З. 2, 304
- Григорчак И. И., Лукиянец Б. А., Ковалюк З. Д., Козымик И. Д., Бахматюк Б. П., Бойчук В. В. Влияние интеркаляции литием на положение уровня Ферми и концентрацию свободных носителей заряда в теллуриде висмута. 11, 2083
- Григорьева Г. М., см. Баринаова Э. Ю. 3, 582
- Григорян Г. Е., см. Арутюнян В. М. 3, 505
- Гринштейн П. М., Гучетль Р. И., Заблоцкий В. В., Иванов Н. А., Космач В. Ф., Леонов Н. Н., Петренко В. В., Стук А. А., Федоров В. В., Харченко В. А., Юрова Е. С. Исследование флуктуаций удельного сопротивления в γ -легированном кремнии. 6, 1088
- Гринь В. Ф., см. Бакши И. С. 3, 571
- Гриняев С. Н., Караваев Г. Ф., Тютерев В. Г. Расчет параметров междолинного рассеяния на фононах в полупроводниковых кристаллах АШВ⁷. 8, 1458
- Гришина С. П., см. Марков А. В. 10, 1791
- Гроза А. А., Куц В. И., Литовченко П. Г., Хиврич В. И. Влияние облучения 50 МэВ протонами на ИК поглощение в кремнии. 6, 975
- Громовой Ю. С., Дарчук С. Д., Коновалов В. Н., Лакеенков В. М., Пляцко С. В., Сизов Ф. Ф. Состояние Eu и Mn в теллуриде свинца. 6, 1025
- Грузинов Б. Ф., см. Коржуев М. А. 9, 1545
- Грушка Г. Г., см. Малик А. И. 11, 2049
- Гуральник И. Р., см. Алимниев В. Н. 2, 372
- Гуревич Ю. Г., Зозуля В. Л., Юрченко В. Б. Отрицательное дифференциальное сопротивление при охлаждении электронов в неоднородно легированном полупроводнике. 4, 643
- Гуревич Ю. Г., см. Бочков А. В. 10, 1752
- Гуревич Ю. Г., см. Гредескул Т. С. 4, 717
- Гуревич Ю. Г., см. Гредескул Т. С. 5, 905
- Гуревич Ю. Г., см. Гредескул Т. С. 10, 1895
- Гусаков Г. М., Кодратова Т. Н., Капский А. С., Ларюшин А. И. Влияние импульсного лазерного облучения на профили подвижности и проводимости эпитаксиальных слоев GaAs. 10, 1864
- Гусев В. Э., Жданов Б. В., Кузнецов В. И., Петросян Е. Г., Теленков С. А. Акустическая регистрация удержания фотозобужденной невырожденной электронно-дырочной плазмы вблизи поверхности германия. 2, 366
- Гусева Н. Б., см. Витман Р. Ф. 5, 919
- Гусева Н. Б., см. Лебедев А. А. 12, 2227
- Гусейнов А. А., см. Андаспаева А. А. 8, 1373
- Гуткин А. А., см. Аверкиев Н. С. 1, 73
- Гуткин А. А., см. Аверкиев Н. С. 11, 2072
- Гуцев Г. Л., Мякенькая Г. С. Взаимодействие кислорода с дефектами решетки и примесными атомами в кремнии. 6, 1042
- Гуцев Г. Л., см. Гордеев В. А. 3, 493
- Гучетль Р. И., см. Гринштейн П. М. 6, 1088
- Давыдов А. Б., Штрапенин Г. Л. Переход металл—диэлектрик в бесщелевых полупроводниках p -Hg_{1-x}Cd_xTe с $x \approx 0.15$. 4, 715
- Давыдов В. Н., Лоскутова Е. А., Найден Е. П. Запоздывающие структурные изменения в полупроводниках, стимулированные магнитным полем. 9, 1596
- Давыдов И. А., см. Черкасов Ю. А. 9, 1572
- Далиев Х. С., см. Лебедев А. А. 12, 2227
- Даревский А. С., см. Аношин Ю. А. 6, 937
- Дарчук С. Д., см. Громовой Ю. С. 6, 1025
- Дашевский М. Я., Корляков Д. Н. Влияние германия на образование термодоноров в монокристаллах кремния. 4, 732
- Девятков М. Н., Кашинцева В. Л., Овчинникова Г. И. Дислокационная проводимость восстановленного рутила. 4, 751
- Дегтярев Ю. А., Константинов П. П., Майлина Х. Р., Прокофьева Л. В. Переменная валентность в

- твердом растворе $Pb_{1-x}Sn_xSe$ ($x=0.15$), легированном натрием. 9, 1576
- Демидов Е. С., Карзанов В. В., Павлов П. В. Влияние плотности ионного тока при имплантации на эффект дальнего действия в кристаллах кремния с примесью железа. 3, 548
- Демидов Е. С., см. Карзанов В. В. 11, 2064
- Денисов А. А., см. Кадушкин В. И. 7, 1199
- Денисов А. А., см. Кадушкин В. И. 9, 1702
- Денисов А. А., см. Кадушкин В. И. 10, 1721
- Дерябина Т. И., см. Раданцев В. Ф. 2, 346
- Джабер А. М., Качлишвили З. С. Нелинейная вольтамперная характеристика (ВАХ) полупроводников в сильном электрическом поле. 8, 1500
- Джафарова М. И., см. Аскеров Б. М. 7, 1275
- Джахутапшвили Т. В., Михелашвили В. М., Сагинури М. И., Скакут Т. А., Чиковани Р. И. Светоизлучающие приборы с длиной волны 520–550 нм на основе $Ga_{1-x}Al_xP$. 12, 2198
- Джиоев Р. И., Кавокин К. В., Кусраев Ю. Г., Меркулов И. А. «Оптическая откачка» спинов носителей заряда стимулированной люминесценцией. 1, 104
- Дзамукашвили Г. Э., Качлишвили З. С. Эффект Ганна и субмиллиметровая ОДП в $E \perp H$ полях. 6, 1101
- Дидик В. А., см. Которова Л. Ф. 4, 706
- Димаксян М. Л., см. Арутюнян В. М. 3, 505
- Дирдиев С. А., см. Крутоголов Ю. К. 5, 887
- Дмитриев В. А., Коган Л. М., Морозенко Я. В., Царенков Б. В., Челноков В. Е., Черенков А. Е. Фиолетовый SiC-4H-светодиод. 1, 39
- Дмитриев С. Г. О захвате электрона в приповерхностную энергетическую яму полупроводника. 10, 1845
- Дмитрук Н. Л., см. Борковский О. Ю. 2, 207
- Дмитрук Н. Л., см. Борковская О. Ю. 12, 2113
- Дмитрук Н. Л., см. Быковский В. Ю. 4, 729
- Добровольский В. Н., Винославский М. Н., Павлюк С. П., Коломицкий Н. Г. О механизме работы диодного стабилизатора тока. 3, 416
- Довженко С. В., см. Крутоголов Ю. К. 5, 887
- Додин Е. П., Красильник З. Ф. Моделирование явлений переноса горячих дырок кремния в $E \parallel H$ полях методом Монте-Карло. 4, 585
- Долбая А. Ш., см. Соболев М. М. 6, 1058
- Долгинов А. М., см. Виноградова Г. И. 7, 1177
- Долгинов А. М., см. Виноградова Г. И. 9, 1651
- Долгих Н. И., см. Быковский В. А. 11, 1981
- Долманов И. Н., Рыжиков В. И., Толстихин В. И. К теории туннельно-резонансного инжектора. 3, 499
- Долманов И. Н., см. Толстихин В. И. 11, 1997
- Доманевский Д. С., Жоховец С. В. Влияние корреляции в распределении легирующих примесей на спектр краевой люминесценции сильно легированного арсенида галлия. 4, 693
- Доманская Л. И., см. Городилов Н. А. 2, 316
- Домашевская Э. П., см. Голикова О. А. 3, 450
- Домашевская Э. П., см. Терехов В. А. 2, 268
- Дорин В. А., Лаврентьев А. А., Савицкий О. Г. Температурная инверсия флуктуаций тока. 8, 1501
- Драпак С. И., Катеринчук В. Н., Ковалюк З. Д., Манассон В. А. Особенности инжекции несонных носителей заряда в анизотропной ПТДИ структуре. 8, 1510
- Дрозд В. Е., Романовичев А. И., Рыжков С. А., Рыкова М. А., Ципер Е. В. Туннельные МДП контакты на основе PbTe, полученные методом химической сборки. 11, 2085
- Дружинин Ю. П., Чиркова Е. Г. Длинноволновая фотопроводимость компенсированного германия с медью. 4, 756
- Дружинина Л. В., Молодцова Е. В., Кожухова Е. А., Поляков А. Я., Пошков А. Н., Тишкин М. В., Шленский А. Л. Изучение спектра глубоких центров в антимониде индия методом РСГУ. 11, 2088
- Дугаев В. К., Петров П. П. Энергетический спектр носителей, описываемых моделью Дирака, в квантовой яме. 3, 488
- Дугаев В. К., Петров П. П. Уровни, создаваемые короткодействующим потенциалом дефектов и примесей, в квантовых ямах на основе полупроводников типа A^IVB^VI . 12, 2238
- Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е. Модель объемного шума $1/f$ в полупроводниках. 2, 283
- Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е. Модель объемного шума $1/f$ в лавинно-пролетных диодах. 7, 1187
- Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л. Шум $1/f$ и долговременная релаксация фотопроводимости в GaAs. 10, 1828
- Дыкман И. М. Собственные колебания в сверхрешетке, образованной когерентными лучами в многодолинном полупроводнике. 4, 621
- Дымова Н. Н., см. Акимченко И. П. 6, 1093
- Евгеньев С. Б., Лапкина И. А., Озеров Ю. П., Уфимцев В. Б. Исследование поведения примесей при ионной имплантации селеном GaAs. 8, 1347
- Евстропов В. В., см. Аникин М. М. 4, 647
- Евстропов В. В., см. Аникин М. М. 10, 1813
- Евтихеев В. П., Копьев П. С., Надточий М. Ю., Устинов В. М. Осо-

- бенности эффекта устойчивой фотопроводимости в селективно легированных двойных гетероструктурах GaAs/n-(Al, Ga)As. 5, 845
- Егорова М. В., см. Воробьева В. В. 9, 1699
- Екимов А. И., Крейнгольд Ф. И., Куликин Б. С. Влияние высокого гидростатического давления на экситонный спектр микрокристаллов CdS в стекле. 9, 1556
- Елисеев В. В., см. Выжигин Ю. В. 3, 581
- Емцев В. В., см. Абдусаттаров А. Г. 12, 2221
- Емцев В. В., см. Витовский Н. А. 1, 184
- Емцев В. В., см. Витовский Н. А. 3, 425
- Ендриховский С. А., Ройзин Я. О., Свиридов В. Н., Цыбенков Л. В. Токовая деградация гетероструктур на основе α -Si: Н. 3, 444
- Ерастова Е. Н., см. Безручко Ё. П. 9, 1707
- Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б., Шокина Е. В. Об использовании кремниевых структур типа М—П—М в методе емкостной спектроскопии глубоких уровней. 9, 1613
- Еремин В. К., см. Андреев В. М. 3, 478
- Ермаков В. Н., см. Берча А. И. 12, 2244
- Ермаков М. Г., см. Поляков В. И. 1, 125
- Ермаков О. Н., см. Поляков В. И. 1, 125
- Ермолин А. В., Кучма А. Е., Свердлов В. А. К теории плазменных волн в слоистых структурах. 9, 1709
- Ерчак Д. П., Кособуцкий В. С., Стельмах В. Ф. Структура компенсирующих центров в облученном нейтронами n -германии. 9, 1539
- Ершов С. Г., см. Ершова Т. П. 2, 323
- Ершова Т. П., Ершов С. Г., Жуков В. Е., Кораблев В. В., Тюкин В. Ю. Методика и результаты исследования кинетики поверхностной ЭДС в GaAs. 2, 323
- Жадько И. П., см. Гасан-заде С. Г. 1, 85
- Ждан А. Г., см. Байрамов М. А. 9, 1618
- Ждан А. Г., см. Байрамов М. А. 12, 2122
- Жданов Б. В., см. Гусев В. Э. 2, 366
- Жданович Н. С., см. Бабаев А. А. 4, 636
- Жданович Н. С., см. Копорова Л. Ф. 4, 706
- Железняк А. Т., Шмелев Г. М. О фотостимулированном продольном магнитосопротивлении полупроводников. 2, 376
- Жепко В. А., см. Берман Л. С. 12, 2129
- Жоховец С. В., см. Доманевский Д. С. 4, 693
- Жузе В. П., Шелых А. И. Оптические свойства и электронная структура полупроводниковых сульфидов и оксидов редкоземельных металлов (обзор). 3, 393
- Жукаускас А., см. Балтрамеюнас Р. 3, 565
- Жуков В. Е., см. Ершова Т. П. 2, 323
- Жуков С. П., см. Аксенов И. А. 9, 1696
- Жукова Н. М., Кашин А. П., Максимов М. З., Марченко О. В. Об оптимизации концентрации носителей в полупроводниковых термоэлементах. 10, 1908
- Заблочный В. В., см. Гринштейн П. М. 6, 1088
- Заболоцкий Е. И., см. Поморцев Р. В. 10, 1796
- Заветова М., см. Акимченко И. П. 6, 1093
- Завьялов В. В., см. Раданцев В. Ф. 2, 346
- Задорожный Н. С., см. Алешин А. М. 6, 1116
- Зайтов Ф. А., см. Абасова А. З. 1, 152
- Зайнабидинов С. З., Тураев А. Р., Фистуль В. И., Ходжаев М. Д. Распад преципитатов никеля в монокристаллах кремния под влиянием всестороннего сжатия. 12, 2118
- Зайнабидинов С., см. Азимов Г. К. 3, 556
- Зайнабидинов С. З., см. Азимов Г. К. 10, 1890
- Закс М. Б., см. Абдурахманов К. П. 10, 1891
- Залубинская Л. Н., Кронберг А. В., Пастернак В. А. Моделирование диффузионного процесса в поликристаллических пленках сульфида кадмия.* 3, 579
- Зарицкий И. М., см. Бугай А. А. 5, 872
- Засавицкий И. И., Мационашвили Б. Н., Трофимов В. Т. Зависимость от состава параметров глубокого центра в эпитаксиальных слоях $Pb_{1-x}Sn_xTe(In)$. 11, 2019
- Заставной А. В., Король В. М. Взаимодействие лития с радиационными дефектами в кремнии. 2, 369
- Захаренков Л. В., Касаткин В. А., Савельев В. П. Влияние концентрации электронов на эффективность возбуждения люминесценции Yb^{3+} в $InP(Yb)$. 8, 1515
- Захаренков Л. Ф., см. Байрамов Б. Х. 8, 1496
- Захаренков Л. Ф., см. Мастеров В. Ф. 12, 2229
- Захаров С., см. Адомайтис Э. 6, 1096
- Захарова А. А., Рыжий В. И. О механизме образования пространственно-неоднородных структур в полупроводниках под действием мощного лазерного излучения. 10, 1898
- Захарова А. А., Рыжий В. И. О генерации звука при воздействии на поверхность полупроводника лазерного излучения. 11, 1976
- Заяц Н. С., см. Глинчук К. Д. 4, 657
- Заячук Д. М., Иванчук Д. Д., Иванчук Р. Д., Микитюк В. И., Старик П. М. Магнитная восприимчивость теллурида свинца, легированного галлием. 9, 1654
- Зверев Л. П., см. Раданцев В. Ф. 2, 346
- Земан Я., см. Выжигин Ю. В. 4, 719
- Зерагия Э. М., см. Мартынов В. Н. 1, 168
- Зимогоорова Н. С., см. Андреев В. М. 4, 612
- Зинченко Э. А., см. Гасан-заде С. Г. 1, 85
- Зломанов В. П., см. Акимов Б. А. 2, 244

- Зобов Е. М., Ризаханов М. А. Инжекционное очувствление симметричных МПМ структур на основе CdSe<Ag> в среднем диапазоне ИК света. 7, 1291
- Зозуля В. Л., см. Гуревич Ю. Г. 4, 643
- Золотарев М. Л., см. Полыгалов Ю. И. 2, 279
- Золотов С. И., см. Ковалев А. Н. 6, 968
- Золотухина В. В., Мисюра И. В. Магнитная восприимчивость при структурном фазовом переходе в узкощелевых полупроводниках $Pb_{1-x}Sn_xSe$. 4, 728
- Зотова Н. В., см. Айдаралиев М. 4, 592
- Зубков В. И., Пихтин А. Н., Соломонов А. В. Нестационарная емкостная спектроскопия глубоких уровней в твердых растворах: донорный уровень в $GaAs_{1-x}P_x$. 1, 64
- Зубрилов А. С., Котин О. А., Шуман В. Б. Однородный лавинный пробой в кремниевых диодах. 4, 607
- Зыков В. Г., Сердега Б. К. Фотомангнитная ЭДС в Ge, возбуждаемая поляризованным светом. 6, 1118
- Ибрагимова М. И., Барышев Н. С., Хайбуллин И. Б., Ахмедова Ф. И., Фадеева А. П. Электрические свойства имплантированных He^+ , Cu^+ , Ag^+ и термически ожоженных кристаллов $Cd_xHg_{2-x}Te$. 7, 1249
- Иванов А. М., см. Еремин В. К. 9, 1613
- Иванов Б. В., см. Воронков В. П. 3, 562
- Иванов Н. А., см. Гринштейн П. М. 6, 1088
- Иванов С. В., Копьев П. С., Некрасов В. Ю., Пахомов А. Г., Трухин В. Н., Ярошецкий И. Д. Энергетическая релаксация и транспорт электронов и дырок в короткопериодичных полупроводниковых сверхрешетках. 9, 1564
- Иванова Т. М., см. Терехов В. А. 2, 268
- Иванов - Омский В. И., см. Барановский С. Д. 8, 1434
- Иванов - Омский В. И., см. Гельмонт Б. Л. 8, 1440
- Иванов - Омский В. И., см. Гельмонт Б. Л. 10, 1874
- Иванчук Д. Д., см. Заячук Д. М. 9, 1654
- Иванчук Р. Д., см. Заячук Д. М. 9, 1654
- Иванюкович В. А., Карась В. И., Ломако В. М. Конфигурационные перестройки бистабильных центров в ковалентных полупроводниках — фазовые переходы второго рода. 2, 264
- Иванюкович В. А., Карась В. И., Ломако В. М. Структура пика E_3 в арсениде галлия. 9, 1635
- Иващенко В. М., см. Вагидов Н. З. 2, 304
- Ивченко Е. Л., см. Гашизмзаде Н. Ф. 5, 839
- Игнатьева Л. А., см. Монозон Б. С. 10, 1800
- Ильин Н. П., см. Васильев А. Э. 5, 804
- Ильменков Г. В., см. Байрамов Б. Х. 8, 1496
- Имамкулиев С. Д., см. Аброян И. А. 2, 352
- Имамов Э. З., см. Аверкиев Н. С. 7, 1193
- Именков А. Н., см. Андаспаева А. А. 8, 1373
- Инишева О. В., см. Германенко А. В. 5, 796
- Ирха В. И., см. Викулин И. М. 6, 1006
- Исаев А. И., Казакова Л. П., Лебедев Э. А., Ятлинко И. И. Увеличение дрейфовой подвижности носителей заряда в халькогенидных стеклообразных полупроводниках при легировании бором. 1, 181
- Исмаилов И. А., см. Гасанова А. Т. 2, 236
- Истратов А. А., см. Вывенко О. Ф. 8, 1521
- Итальянцев А. Г., см. Омелян-ская Н. М. 8, 1503
- Ицкевич Е. С., см. Кучеренко И. В. 10, 1784
- Кабдин Н. Н., см. Бугай А. А. 5, 872
- Кавокин К. В., см. Джзоев Р. И. 1, 104
- Каган В. Д. Влияние быстроосциллирующего движения электронов в сильном магнитном поле или высокочастотном электрическом поле на ударную ионизацию. 1, 96
- Каган В. Д., Карпенко С. Л., Катилюс Р., Мюллер Г. О., Сейсян Р. П., Якобсон М. А. Гашение экситонной люминесценции в результате ударной ионизации и механизмы релаксации электронов в сульфиде кадмия. 1, 138
- Каган М. Б., см. Баринаова Э. Ю. 3, 582
- Кодалашвили М. З., см. Бакши И. С. 3, 571
- Кадушкин В. И., Денисов А. А., Колосова С. В. Время релаксации импульса 2D-электронов $n-Al_xGa_{1-x}As/GaAs$ в классическом магнитном поле. 10, 1721
- Кадушкин В. И., Денисов А. А., Сеничкин А. П. Эффективная температура и релаксация энергии 2D-электронов $n-Al_xGa_{1-x}As/GaAs$. 7, 1199
- Кадушкин В. И., Денисов А. А., Сеничкин А. П. Аномалии низкотемпературной проводимости канала с 2D-электронами гетероструктуры $n-Al_xGa_{1-x}As/GaAs$. 9, 1702
- Казакевич Л. А., Лугаков П. Ф., Филиппов И. М. Рекомбинация носителей заряда на дислокациях и радиационных дефектах в $p-Si$. 4, 722
- Казакевич Л. А., Лугаков П. Ф., Филиппов И. М. Особенности накопления рекомбинационных центров при облучении $p-Si$. 4, 748
- Казакова Л. П., см. Исаев А. И. 1, 181
- Казанин М. М., см. Голикова О. А. 3, 450
- Казанин М. М., см. Голикова О. А. 10, 1737
- Казанский А. Г., Милличев Е. П. Дефектообразование в $a-Si$: H при дегидрогенизации и оптической деградации. 11, 2027
- Казаринов Ю. Н., Ломасов В. Н. Кинетика накопления доноров в селениде свинца при корпускулярном облучении. 1, 177
- Казарян С. А., Гиппиус А. А., Вавилов В. С. Взаимодействие имплантированных атомов никеля с дефектами

- и примесями в природном алмазе (по данным люминесценции). 4, 156
- Казьмин С. А., см. Аброян И. А. 2, 352
- Кайданов В. И., см. Аброян И. А. 2, 352
- Калмыкова Н. П., Мазец Т. Ф., Сморгонская Э. А., Цэндин К. Д. Микронеоднородности и примесная проводимость в пленках стеклообразного As_2Se_3 , легированного Вi. 2, 297
- Калягин М. А., Стриковский М. Д. Формирование проводящих слоев при облучении поверхности кремния лазерной плазмой бора и при последующем отжиге. 6, 964
- Каминский А. С., см. Горбунов М. В. 2, 359
- Каминский В. Э. Уровни энергии и волновые функции электронов в потенциальной яме селективно легированных гетероструктур. 4, 662
- Камушадзе Т. Д., см. Соболев М. М. 6, 1058
- Каничев М. Р., см. Бордовский Г. А. 4, 616
- Канцер В. Г., Малкова Н. М., Тофан В. А. Электронная зонная структура монослойных сверхрешеток (111) из узкозонных полупроводников A^IVB^VI . 11, 2006
- Каплан Б. И., см. Владимиров В. В. 6, 1104
- Каплан Б. И., см. Владимиров В. В. 6, 1106
- Капский А. С., см. Гусаков Г. М. 10, 1864
- Караваев Г. Ф., Ткаченко Е. А., Уйманов Е. В. Исследование процессов квазибаллистического транспорта электронов в прямозонных полупроводниковых соединениях типа $A^{III}B^V$. 11, 1938
- Караваев Г. Ф., см. Гриняев С. Н. 8, 1458
- Карандашев С. А., см. Айдаралиев М. 4, 592
- Карась В. И., см. Иванюкович В. А. 2, 264
- Карась В. И., см. Иванюкович В. А. 9, 1635
- Карачевцева Л. А., см. Бакши И. С. 3, 571
- Карзанов В. В., Павлов П. В., Демидов Е. С. Влияние ионной бомбардировки на кинетику распада твердого раствора хрома в кремнии. 11, 2064
- Карзанов В. В., см. Демидов Е. С. 3, 548
- Карлик И. Я., см. Алексеев М. А. 5, 761
- Карлина Л. Б., см. Андреев В. М. 4, 612
- Карпенко С. Л., см. Каган В. Д. 1, 138
- Карпов В. Г., см. Безлюдный С. В. 11, 2013
- Карпова И. В., Перель В. И., Сыроегин С. М. Оже-рекомбинация в сильно легированном германии. 5, 826
- Карпова И. В., Сабликов В. А. О рекомбинационных волнах в условиях эксклюзии. 7, 1293
- Карпова Н. Ю., см. Балагуров Л. А. 4, 673
- Карпович И. А., Бедный Б. И., Байдусь Н. В., Планкина С. М., Степихова М. В., Шилова М. В. Барьерная фотопроводимость в эпитаксиальных пленках $GaAs$ и InP . 12, 2164
- Карпович И. А., см. Бедный Б. И. 2, 362
- Карпович С. И., см. Тихов С. В. 9, 1694
- Карягин В. В., см. Ляпилин И. И. 3, 552
- Касаманли Г. Д., см. Аброян И. А. 2, 352
- Касаткин А. П., см. Тихов С. В. 9, 1694
- Касаткин В. А., см. Васильев А. Э. 11, 2069
- Касаткин В. А., см. Захаренков Л. В. 8, 1515
- Касаткин В. В., см. Абдурахманов К. П. 10, 1891
- Касиян В. А., см. Тимченко И. Н. 2, 240
- Катеринчук В. Н., см. Драпак С. И. 8, 1510
- Катиллюс Р., см. Каган В. Д. 1, 138
- Качлишвили З. С., см. Джабер А. М. 8, 1500
- Качлишвили З. С., см. Даамукашвили Г. Э. 6, 1101
- Качурин Г. А., Тыщенко И. Е., Попов В. П., Тийс С. А., Плотиных А. Е. Имплантация азота в кремний при 700—1100 °С. 3, 434
- Кашин А. П., см. Жукова Н. М. 10, 1908
- Кашинцева В. Л., см. Девятков М. Н. 4, 751
- Каширская Л. М., Кучеренко И. В., Свистов А. Е. Допустимые значения параметров уровня собственных дефектов в твердых растворах свинец—олово—селен. 2, 382
- Каширская Л. М., Кучеренко И. В., Свистов А. Е. Флукуации дна зоны проводимости в твердых растворах свинец—олово—селен. 4, 742
- Каширская Л. М., см. Кучеренко И. В. 10, 1784
- Кашкаров В. М., см. Терехов В. А. 2, 268
- Кашкаров П. К., Петров В. И., Птицын Д. В., Тимошенко В. Ю. Образование упорядоченных структур на поверхности GaAs при импульсном лазерном облучении. 11, 2080
- Кенгерли Д. Ф., см. Алекперов С. А. 12, 2138
- Кернер Б. С., см. Ващенко В. А. 8, 1378
- Кибис О. В. Влияние деформации на энергетический спектр валентной зоны в двумерных полупроводниковых системах. 5, 820
- Кикоин К. А., Курек И. Г., Мельничук С. В. Энергетический спектр примесей 3d-элементов в CdTe. 12, 2153
- Ким С. Г., см. Глазов В. М. 1, 187
- Ким С. Г., см. Глазов В. М. 8, 1469
- Ким С. Г., см. Глазов В. М. 10, 1834
- Киракосян А. А., см. Вартаян А. Л. 10, 1851
- Киселев В. С., см. Авраменко С. Ф. 3, 521
- Кисин М. В. Пограничные состояния в зоне проводимости резкого гетероперехода. 2, 292
- Кияк С. Г., Крачун В., Маненков А. А., Медяну Р., Михайлова Г. Н., Михэилеску И. Н., Прохоров А. М., Урсу И. Твердофазное легирование кремния под действием не-

- прерывного излучения CO_2 -лазера. 3, 421
- Кияк С. Г., см. Бончик А. Ю. 10, 1893
- Клинер П. М., см. Берман Л. С. 11, 1947
- Клопиков Е. Б., см. Гирка А. И. 2, 328
- Клюканов А. А., Сенокосов Э. А., Федоров В. М. Коллективные процессы в примесном рекомбинационном излучении прямозонных полупроводников. 3, 542
- Книгин П. И., Мирсагатов Ш. А., Розиков Х. Фотоприемник УФ излучения на базе пленки $Zn_xCd_{1-x}S$. 2, 356
- Князев А. Ф., см. Лашкул А. В. 8, 1406
- Кобелев В. Ф., см. Аскеров И. М. 7, 1307
- Ковалев А. Н., Остробородова В. В., Парамонов В. И., Фоломин П. И. Проявление неоднородностей в легированных халькогенидах свинца по гальваномагнитным свойствам. 11, 2039
- Ковалев А. Н., Фоломин П. И., Золотов С. И. Влияние глубоких уровней на свойства легированного $PbTe$. 6, 968
- Ковалев А. Н., см. Колесников И. В. 6, 960
- Ковалев Л. Е., см. Горя О. С. 11, 2090
- Коваленко В. Ф., Пека Г. П., Токкалин О. А., Химичев А. И. Определение скорости поверхностной рекомбинации в тонких варизонных структурах. 6, 1108
- Коваленко В. Ф., см. Алешин А. М. 6, 1116
- Коваленко В. Ф., см. Городниченко О. К. 12, 2214
- Коваль А. В., см. Сушкевич К. Д. 4, 737
- Ковальчук М. В., Кон В. Г., Лобанович Э. Ф. Структурная чувствительность кривых фотоэдс в условиях образования стоячей рентгеновской волны в полупроводнике с $p-n$ -переходом. 6, 1054
- Ковалюк З. Д., см. Григорчак И. И. 11, 2083
- Ковалюк З. Д., см. Драпак С. И. 8, 1510
- Коган Л. М., см. Дмитриев В. А. 1, 39
- Кодратова Т. Н., см. Гусаков Г. М. 10, 1864
- Кожухова Е. А., см. Дружинина Л. В. 11, 2088
- Козлов Ю. И., см. Азимов Г. К. 10, 1890
- Козлова С. Г., см. Соболев В. В. 8, 1430
- Козьмик И. Д., см. Григорчак И. И. 11, 2083
- Козуб В. И. Новые книги по полупроводникам. 2, 386; 5, 925; 6, 1123; 9, 1716; 11, 2101
- Колесник С. П., см. Лашкарев Г. В. 5, 874
- Колесников И. В., Ковалев А. Н., Сипатов А. Ю., Парамонов В. И., Федоренко А. И., Юнович А. Э. Квантово-размерные эффекты в фотолуминесценции сверхрешеток на основе халькогенидов свинца. 6, 960
- Колесников И. В., Сипатов А. Ю. Фотолуминесценция сверхрешеток $PbS-EuS$. 6, 954
- Колесников Н. В., Ломосов В. Н., Мальханов С. Е. Влияние зарядовых состояний вакансий на накопление дивакансий в кремнии при электронном облучении. 11, 1921
- Колесников Н. В., см. Безлюдный С. В. 11, 2013
- Колесников Н. В., см. Безлюдный С. В. 11, 2013
- Колесников Н. В., см. Безлюдный С. В. 11, 2013
- Коловский И. И., Лугаков П. Ф., Шуша В. В. Особенности образования рекомбинационных центров при облучении бездислокационного $n-Si$. 5, 885
- Коллюх А. Г., см. Владимиров В. В. 6, 1106.
- Коллюх А. Г., см. Владимиров В. В. 6, 1104
- Колобов А. В., Любин В. М., Тагирджанов М. А. Электрические и фотоэлектрические свойства пленочного стеклообразного сульфида мышьяка, фототермолегированного цинком. 4, 601
- Коломицкий Н. Г., см. Добровольский В. Н. 3, 416
- Коломоец В. В., см. Берча А. И. 12, 2244
- Колосова С. В., см. Кадушкин В. И. 10, 1721
- Кольцов В. Б., см. Регель А. Р. 7, 1129
- Кольцов Г. И., Крутенюк Ю. В. Туннелирование и поверхностные состояния в контакте $Au-InAs$ p -типа. 11, 1986
- Кольцов Г. И., Ладыгин Е. А., Юрчук С. Ю. Изменение спектра глубоких уровней в $GaAs_{1-x}P_x$ в процессе создания ионно-имплантированных $p-n$ -переходов.* 7, 1320
- Кольцов Г. И., Юрчук С. Ю. Влияние глубоких центров, введенных в $GaAs_{1-x}P_x$ ионной имплантацией и электронным облучением, на спектральные характеристики фоточувствительных структур. 10, 1906
- Кольченко Т. И., Ломако В. М., Родионов А. В., Свешников Ю. Н. Особенности дефектообразования в эпитаксиальном арсениде галлия, содержащем изовалентную примесь индия. 4, 626
- Кольченко Т. И., Мороз С. Е. О возможной природе остаточных глубоких центров в фосфиде индия. 3, 546
- Кольченко Т. И., см. Быковский В. А. 1, 166
- Комаров А. В., см. Абрамишвили В. Г. 3, 575
- Комиссаров Г. П., см. Манассон В. А. 3, 557
- Комолов Е. Н., см. Анатычук Л. И. 7, 1320
- Комолов Е. Н., см. Анатычук Л. И. 7, 1321
- Кон В. Г., см. Ковальчук М. В. 6, 1054
- Кондратьева О. Г., Неустров Л. Н., Осипов В. В. К теории вертикального ЛСР фоторезистора. 3, 536
- Кондратьева О. Г., Неустров Л. Н., Осипов В. В. Флуктуации поперечного тока в легированной сверхрешетке. 10, 1741
- Конников С. Г., Салата О. В., Соловьев В. А., Синицын М. А., Уманский В. Е., Винокуров

- Д. А. Определение электрофизических параметров тонких гетерозитаксиальных слоев в растровом электронном микроскопе (эксперимент). 8, 1416
- Конников С. Г., Соловьев В. А., Уманский В. Е., Чистяков В. М. Определение электрофизических параметров тонких гетерозитаксиальных слоев в растровом электронном микроскопе (теория). 8, 1411
- Конников С. Г., см. Брунок П. Н. 6, 1689
- Конников С. Г., см. Соболев М. М. 6, 1058
- Коновалов В. Н., см. Громовой Ю. С. 6, 1025
- Коноплева Р. Ф., см. Пустовойт А. К. 2, 257
- Конорова Л. Ф., Жданович Н. С., Дидик В. А., Прудников И. М. О структурных изменениях в стеклообразном As_2Se_3 , облученном большими дозами нейтронов. 4, 706
- Константинов А. О. Температурная зависимость ударной ионизации и лавинного пробоя в карбиде кремния. 1, 52
- Константинов А. О. Шнурование лавинного пробоя в карбиде кремния. 6, 985
- Константинов О. В., Львова Т. В., Паханов М. М. «Моттовское» плато на вольтёмкостной характеристике диода Шоттки с гетеропереходом. 7, 1283
- Константинов О. В., Мезрин О. А., Трошков С. И. Теория квазибаллистического транспорта электронов в биполярном гетеротранзисторе с сильно легированной субмикронной базой. 3, 508
- Константинов П. П., см. Дегтярев Ю. А. 9, 1576
- Константинова Н. Н., Рудь Ю. В. Оптические свойства монокристаллов $AgGaTe_2$. 10, 1778
- Копьев П. С., Надточий М. Ю., Устинов В. М. О «нулевых осцилляциях» в структурах с двумерным электронным газом. 6, 1110
- Копьев П. С., Надточий М. Ю., Устинов В. М., Механизмы нестационарной фотопроводимости в селективно легированных гетероструктурах $GaAs/n-(Al, Ga)As$. 8, 1382
- Копьев П. С., Решина И. И. Спектр поглощения структур с квантовыми ямами. 7, 1316
- Копьев П. С., см. Васильев А. М. 12, 2133
- Копьев П. С., см. Евтихий В. П. 5, 845
- Копьев П. С., см. Иванов С. В. 9, 1564
- Копылов А. В., см. Аронзон Б. А. 3, 471
- Кораблев В. В., см. Ершова Т. П. 2, 323
- Коржув М. А., Банкина В. Ф., Грузинов Б. Ф., Бушмарина Г. С. Электрофизические свойства суперionного $Cu_{2-x}Se$. 9, 1545
- Корзун Б. В., см. Аксенов И. А. 9, 1696
- Коринфский А. Д., см. Мусатов А. Л. 11, 2056
- Корляков А. Б., см. Вакаров Б. С. 7, 1182
- Корляков Д. Н., см. Дашевский М. Я. 4, 732
- Корнеева Л. А., Мазур Е. А., Руденко А. И. Кооперативные эффекты в кильватере быстрых ориентированных частиц в полупроводниках. 5, 832
- Корнеева Л. А., Мазур Е. А., Руденко А. И. Увеличение эффективности электростатического механизма дефектообразования под действием канализованного пучка частиц. 7, 1296
- Корнеева Л. А., Мазур Е. А., Руденко А. И. Радиационно индуцированная стратификация заряда в узкозонных полупроводниках. 11, 1992
- Корнилов Б. В. Оптическая перезарядка примесных центров многозарядных акцепторов при комбинированном и монополярном фотовозбуждении носителей в полупроводниках. 8, 1329
- Коробицкий Б. В., см. Викулин И. М. 6, 1006
- Король В. М., см. Заставной А. В. 2, 369
- Коропчану В. П., см. Перлин Ю. Е. 4, 734
- Коротких В. Л., см. Мусатов А. Л. 6, 994
- Коротков В. А., см. Горя О. С. 11, 2090
- Коршунов Ф. П., Радауцан С. И., Соболев Н. А., Тигиняну И. М., Урсаки В. В., Кудрявцева Е. А. Краевая фотолюминесценция кристаллов $n-InP$, облученных электронами с энергией 3.5-4 МэВ. 9, 1581
- Коршунов Ф. П., см. Выковский В. А. 1, 79
- Коршунов Ф. П., см. Воеводова А. В. 7, 1173
- Космач В. Ф., см. Гринштейн П. М. 6, 1088
- Кособукин В. А., см. Гашимзаде Н. Ф. 5, 839
- Кособуцкий В. С., см. Ерчак Д. П. 9, 1539
- Костылев В. А., см. Выжигин Ю. В. 3, 581
- Костылев В. А., см. Выжигин Ю. В. 4, 719
- Костылев С. А., см. Горев Н. Б. 2, 357
- Косцов Э. Г., см. Бобылев Б. А. 2, 224
- Котин О. А., см. Зубрилов А. С. 4, 607
- Кохановский С. И., см. Абдуллаев М. А. 2, 201
- Кохановский С. И., см. Абдуллаев М. А. 7, 1156
- Кохановский С. И., см. Абдуллаев М. А. 7, 1160
- Кочетов Ю. А., Макаров Е. А., Шадрин В. С. Пьезосопротивление короткоканальных МДП транзисторов. 10, 1904
- Кошуг О. С., см. Абдуллаев М. А. 7, 1160
- Кравченко А. Ф., см. Воронин С. Т. 5, 787
- Кравченко С. Н., см. Вакаров Б. С. 7, 1182
- Крамарь В. М., см. Соболев В. В. 8, 1430
- Красикова О. Г., см. Аверкиев Н. С. 1, 73

- Красильник З. Ф., см. Додин Е. П. 4, 585
- Краснобаев Л. Я., см. Омеляновская Н. М. 8, 1503
- Краснов В. А., см. Алешин А. М. 6, 1116
- Краснопевцев В. В., см. Акимченко И. П. 6, 1093
- Крейнгольд Ф. И., см. Екимов А. И. 9, 1556
- Крещук А. М., см. Воробьева В. В. 9, 1699
- Кривень С. И., см. Гавалешко Н. Н. 6, 943
- Кронберг А. В., см. Залюбинская Л. Н. 3, 579
- Кропотов Г. И., см. Гельмонт Б. Л. 8, 1440
- Кропотов Г. И., см. Гельмонт Б. Л. 10, 1874
- Кроткус А., см. Балинас В. 10, 1859
- Крочук А. С., см. Бабий П. И. 4, 739
- Крупицкая Р. Ю., см. Вейс А. Н. 1, 185
- Крутенюк Ю. В., см. Кольцов Г. И. 11, 1986
- Крутоголов Ю. К., Довженко С. В., Диордиев С. А., Крутоглова Л. И., Кунакин Ю. И., Рыжих С. А. Исследование зонной структуры твердых растворов $In_{1-x}Ga_xP$ с использованием фотоэлектрического метода. 5, 887
- Крутоглова Л. И., см. Крутоголов Ю. К. 5, 887
- Крылов К. Р., Пономарев А. И., Цидильковский И. М., Гавалешко Н. П., Хомяк В. В. Магнитные и электрические свойства $Hg_{1-x}Eu_xTe$ и $Hg_{1-x}Eu_xSe$. 3, 429
- Крысов Г. А., см. Аброян И. А. 5, 892
- Крэчун В., см. Княк С. Г. 3, 421
- Крючков С. В. Об ионизации примесей солитонами в сверхрешетках. 7, 1314
- Крючков С. В. Электростимулированное примесное поглощение ультразвука в полупроводниках со сверхструктурой.* 10, 1917
- Крючков С. В., Сыродоев Г. А. Влияние конечной ширины зоны проводимости на ионизацию примесных центров в условиях воздействия сильных внешних полей. 5, 857
- Кудоярова В. Х., см. Голикова О. А. 3, 450
- Кудоярова В. Х., см. Голикова О. А. 10, 1737
- Кудрявцева Е. А., см. Коршунов Ф. П. 9, 1581
- Кудрявцева Н. В., см. Тихов С. В. 9, 1694
- Кудыкина Т. А., см. Винецкий В. Л. 10, 1910
- Кузнецов В. В., Разбегаев В. Н., Саид Эль-Гизири. Край собственного поглощения $Al_xGa_{1-x}As_{1-y}P_y$. 5, 880
- Кузнецов В. И., Лукаков П. Ф., Салманов А. Р., Цикунов А. В. Накопление и отжиг основных компенсирующих радиационных дефектов в $p-Si<Ge>$. 8, 1492
- Кузнецов В. И., см. Гусев В. Э. 2, 366
- Кузьмин И. А., Машевский А. Г., Строганов Д. Р., Федорова О. М., Явич Б. С. Получение МОС гидридным методом при пониженном давлении и фотолюминесцентные явления исследования $GaAs/AlGaAs$ квантово-размерных структур. 8, 1420
- Кулаев Г. И., см. Раданцев В. Ф. 2, 346
- Кулешин В. А., см. Гирка А. И. 7, 1270
- Кулешин В. А., см. Гирка А. И. 12, 2159
- Кулешов С. М., см. Воронков В. П. 3, 562
- Куликов Г. С., см. Абдурахманов К. П. 10, 1891
- Куликин Б. С., см. Екимов А. И. 9, 1556
- Кульбачинский В. А., см. Абрамов В. В. 9, 1704
- Куляк Л. Л., см. Арушанов Э. К. 1, 58
- Кунакин Ю. И., см. Крутоголов Ю. К. 5, 887
- Куокштис Э., см. Балтрамеюнас Р. 3, 565
- Куокштис Э., см. Балтрамеюнас Р. 5, 792
- Купчишин А. И., см. Пустовойт А. К. 2, 257
- Курек И. Г., см. Кикоин К. А. 12, 2153
- Курова И. А., Мелешко Н. В., Ормонт Н. Н., Лупачева А. Н. Кинетика эффекта Стеблера—Вронского в легированных пленках $a-Si$: Н. 11, 2030
- Курова И. А., Мочалова Д. А., Лупачева А. Н. Аномальный эффект Стеблера—Вронского в легированных бором пленках $a-Si$: Н. 3, 573
- Кусраев Ю. Г., см. Джиоев Р. И. 1, 104
- Кустов В. Е., см. Грехов А. М. 4, 746
- Кутасов В. А., Лукьянова Л. Н. Влияние эффективного параметра рассеяния на массу плотности состояний и подвижность в твердых растворах на основе халькогенидов висмута и сурьмы. 4, 652
- Куч В. И., см. Гроза А. А. 6, 975
- Кучеренко И. В., Каширская Л. М., Мёллман К.-П., Ицкевич Е. С. Гальваномагнитные явления в сплавах $Pb_{0.75}Sn_{0.25}Te$ с малой концентрацией In (0.1 ат%) вблизи бесщелевого состояния. 10, 1784
- Кучеренко И. В., см. Бродовой А. В. 8, 1506
- Кучеренко И. В., см. Каширская Л. М. 2, 382
- Кучеренко И. В., см. Каширская Л. М. 4, 742
- Кучинский В. И., см. Аврутин Е. А. 7, 1207
- Кучинский П. В., Ломако В. М., Петрунин А. П. Инжекционная, электрополевая и термическая перестройка радиационных дефектов в p -кремнии. 9, 1625
- Кучма А. Е., см. Ермолин А. В. 9, 1709
- Кущавилю К. Ш., см. Барниова Э. Ю. 3, 582
- Кюрегян А. С. Прыжковая генерация носителей заряда в ионных слоях полупроводников с непрерывным спектром локализованных состояний. 1, 110

- Кюрегян А. С., Шлыгин П. П. Температурная зависимость напряжения лавинного пробоя $p-n$ -переходов с глубокими уровнями. Режим релаксационной задержки пробоя. 7, 1164
- Кюрегян А. С., Юрков С. Н. Напряжение лавинного пробоя $p-n$ -переходов на основе Si, Ge, SiC, GaAs, GaP и InP при комнатной температуре. 10, 1819
- Лавдовский К. Г., см. Аладашвили Д. И. 2, 213
- Лаврентьев А. А., см. Дорин В. А. 8, 1501
- Лагвилава Т. А., см. Бирюлин Ю. Ф. 6, 1070
- Лагунова Т. С., см. Баранов А. Н. 5, 780
- Ладыгин Е. А., см. Брандт Н. Б. 11, 2034
- Ладыгин Е. А., см. Кольцов Г. И. 7, 1320
- Лазарев В. Б., см. Волков В. В. 8, 1400
- Лазутка А. С., см. Аврутин Е. А. 7, 1207
- Лакеев В. М., см. Громовой Ю. С. 6, 1025
- Лакшина И. А., см. Евгенийев С. В. 8, 1347
- Ларионов В. Р., см. Андреев В. М. 4, 597
- Ларкин И. А. Вертикальный транспорт и фотолюминесценция в сверхрешетках. 9, 1664
- Ларюшин А. И., см. Гусаков Г. М. 10, 1864
- Ласене Г., см. Бумялене С. 8, 1479
- Латинис В., см. Балтрамеюнас Р. 3, 565
- Лашкарев Г. В., Бродовой А. В., Радченко М. В., Колесник С. П., Вертелецкий П. В. Особенности поведения примеси хрома в теллуриде свинца, 5, 874
- Лашкарев Г. В., см. Бродовой А. В. 8, 1506.
- Лашкул А. В., Цишовски Ян, Арушанов Э. К., Князев А. Ф. Влияние гидростатического давления на концентрацию и подвижность электронов в $Cd_{3-x}Zn_xAs_2$. 8, 1406
- Лебедев А. А., Абдурахманов К. П., Витман Р. Ф., Гусева Н. Б., Далиев Х. С., Утамурадова Ш. Б. Влияние кислорода и углерода на поведение марганца в $n-Si$. 12, 2227
- Лебедев А. А., Митрохин В. И., Рембеза С. И., Свиридов В. В., Степанова М. Н., Ярославцев Н. П. Электронно-механический резонанс на глубоких центрах в $p^+-p^0-\pi-n^0$ -структурах арсенида галлия. 5, 897
- Лебедев А. А., см. Витман Р. Ф. 5, 919
- Лебедев А. А., см. Витман Р. Ф. 11, 2066
- Лебедев Э. А., см. Исаев А. И. 1, 181
- Лев Б. И., Торчинская Т. В., Томчук П. М., Шейнкман М. К. Кинетика инжекционно-стимулированного преобразования дефектов в светолучающих GaAs: Si-структурах. 9, 1529
- Левин Е. И., см. Аладашвили Д. И. 2, 213
- Левинштейн М. Е., см. Дьяконова Н. В. 2, 283
- Левинштейн М. Е., см. Дьяконова Н. В. 7, 1187
- Левинштейн М. Е., см. Дьяконова Н. В. 10, 1828
- Левкулич А. Р., см. Микла В. И. 1, 131
- Леонов Н. Н., см. Гринштейн П. М. 6, 1088
- Леринман Н. К., см. Глузман Н. Г. 6, 1032
- Либенсон Б. И. Теория формирования эмиссионного потока Г-электронов из полупроводника с отрицательным электронным сродством. 11, 1927
- Ликунова В. М., см. Выжигин Ю. В. 3, 581
- Липко А. Л., см. Волков А. С. 12, 2179
- Липник А. А. Анизотропные планарные акустимагнитоэлектрические эффекты на мезоультразвуке в произвольных (классических) магнитных полях.* 3, 580
- Липсанен Х., см. Пихтин А. Н. 7, 1280
- Липтуга А. И., см. Ботте В. А. 7, 1303
- Лисянский М. И., Лукьянчикова Н. Б. Исследование природы шума в нестабильных GaP: N-светодиодах. 12, 2143
- Литовский М. А., см. Городецкий С. М. 3, 580
- Литовченко В. Г., см. Борковская О. Ю. 2, 207
- Литовченко П. Г., см. Гроза А. А. 6, 975
- Лихолит Л. Ф., см. Аскеров И. М. 7, 1307
- Лобанова Н. Е., Павлов П. В., Тетельбаум Д. И., Потапова Л. В. Немонотонный характер дозовой зависимости электрических свойств и химической стойкости азотированного поной имплантацией кремния. 12, 2149
- Лобанович Э. Ф., см. Ковальчук М. В. 6, 1054
- Ломако В. М., Старостин П. Я. Рекомбинация носителей заряда в арсениде галлия, содержащем области скопления дефектов. 1, 90
- Ломако В. М., см. Быковский В. А. 1, 166
- Ломако В. М., см. Иванюкович В. А. 9, 1635
- Ломако В. М., см. Иванюкович В. А. 2, 264
- Ломако В. М., см. Кольченко Т. И. 4, 626
- Ломако В. М., см. Кучинский П. В. 9, 1625
- Ломасов В. Н., см. Берман Л. С. 4, 753
- Ломасов В. Н., см. Берман Л. С. 12, 2129
- Ломасов В. Н., см. Казаринов Ю. Н. 1, 177
- Ломасов В. Н., см. Колесников Н. В. 11, 1921
- Лоскутова Е. А., см. Давыдов В. Н. 9, 1596
- Лощинский А. М., см. Виноградова Г. И. 9, 1651
- Лубышев Д. И., Мигаль В. П.,

- Преображенский В. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. Влияние отношения потоков мышьяка и галлия на люминесценцию арсенида галлия, полученного методом молекулярно-лучевой эпитаксии. 10, 1913
- Лубяная М. Д., Марончук И. Е., Юцис А. И. Аномальное поведение затухания акустоудс в эпитаксиальных слоях арсенида галлия. 2, 364
- Луговых П. Ф., Лукашевич Т. А. Особенности образования радиационных дефектов в высокоомном кремнии.* 3, 581
- Луговых П. Ф., см. Казакевич Л. А. 4, 722
- Луговых П. Ф., см. Казакевич Л. А. 4, 748
- Луговых П. Ф., см. Колковский И. И. 5, 885
- Луговых П. Ф., см. Кузнецов В. И. 8, 1492
- Лукашевич П. Г., Павловский В. Н., Самойлюкович В. А. О системе механизмов рекомбинации неравновесных носителей заряда в сильно возбужденных прямозонных полупроводниках.* 3, 578
- Лукашевич Т. А., см. Луговых П. Ф. 3, 581
- Лукашевич П. Г., см. Батырев В. А. 3, 550
- Лукашевич Т. А., Мизрухин Л. В. Влияние температуры на эффективность аннигиляции первичных радиационных дефектов в высокоомном кремнии при γ -облучении. 5, 865
- Лукин С. Н., см. Бугай А. А. 5, 872
- Лукьянец Б. А., см. Григорчак И. И. 11, 2083
- Лукьянова Л. Н., см. Кутасов В. А. 4, 652
- Лукьянченко А. И. Отрицательная дифференциальная фотопроводимость. Эффект ИК гашения фотопроводимости. 5, 882
- Лукьянчикова Н. Б. Ударная ионизация глубоких уровней в лавинно-пролетных диодах на основе арсенида галлия. 2, 332
- Лукьянчикова Н. Б., см. Лисянский М. И. 12, 2143
- Лупачева А. Н., см. Курова И. А. 3, 573
- Лупачева А. Н., см. Курова И. А. 11, 2030
- Лучина В. Г., см. Черкасов Ю. А. 9, 1572
- Львова Т. В., см. Константинов О. В. 7, 1283
- Любин В. М., см. Бордовский Г. А. 4, 616
- Любин В. М., см. Колобов А. В. 4, 601
- Любченко А. В., см. Абасова А. З. 1, 152
- Любченко А. В., см. Вирт И. М. 8, 1386
- Люзе Л. Л., см. Богданова В. А. 10, 1900
- Ляпилин И. И., Карягин В. В. Новый тип осциллирующей кинетических коэффициентов в квантовых структурах. 3, 552
- Мазур Е. А., см. Корнеева Л. А. 5, 832
- Мазур Е. А., см. Корнеева Л. А. 7, 1296
- Мазур Е. А., см. Корнеева Л. А. 11, 1992
- Мазур Ю. И., см. Гавалешко Н. Н. 6, 943
- Майлина Х. Р., см. Дегтярев Ю. А. 9, 1576
- Майсурадзе Р. М., см. Соболев М. М. 6, 1058
- Макаров Е. А., см. Кочетов Ю. А. 10, 1904
- Макаров О. А., Неизвестный И. Г., Синюков М. П., Супрун С. П., Шумский В. Н. Чувствительность гетероструктур Ge—GaAs к освещению в области вакуумного ультрафиолета. 6, 1038
- Макарова Т. В., см. Горев Н. В. 2, 357
- Макарова Т. Л., см. Беляков Л. В. 11, 1966
- Маковецкая Л. А., см. Аксенов И. А. 9, 1696
- Максимов М. З., см. Жукова Н. М. 10, 1908
- Максимова С. А., см. Выжигин Ю. В. 3, 581
- Макушенко Ю. М., см. Абдуллаев М. А. 2, 201
- Макушенко Ю. М., см. Абдуллаев М. А. 7, 1156
- Малик А. И., Гречко В. А., Грушка Г. Г. Механизм генерации электрических колебаний, усиления фототока и S-образной ВАХ в ПДП структурах. 11, 2049
- Маликова Л. В., см. Горя О. С. 11, 2090
- Маликович М. Д., см. Галаев А. А. 5, 916
- Малинский И. М., см. Гайдуков Ю. П. 11, 2098
- Малкова Н. М., см. Канцер В. Г. 11, 2006
- Малкович Р. Ш., см. Скорятина Е. А. 1, 164
- Малькова Н. В., см. Виноградова Г. И. 7, 1177
- Мальханов С. Е., см. Колесников Н. В. 11, 1921
- Малютенко В. К., Тесленко Г. И. Тепловое излучение прямо смещенного полупроводникового диода. 8, 1452
- Малютенко В. К., см. Ботте В. А. 7, 1303
- Малютенко В. К., см. Владимиров В. В. 6, 1104
- Малютенко В. К., см. Владимиров В. В. 6, 1106
- Мамедов Ш. Ф., см. Гасанова А. Т. 2, 236
- Манассон В. А., Комиссаров Г. П. Отрицательная дифференциальная фотопроводимость в МТДП структурах. 3, 557
- Манассон В. А., см. Драпак С. И. 8, 1510
- Маненков А. А., см. Кияк С. Г. 3, 421
- Маргарян А. Л., см. Арутюнян В. М. 11, 2062
- Марков А. В., Степанова И. В., Освенский В. Б., Гришина С. П. Изменение электрических парамет-

- ров полупрозрачного GaAs при термообработке. 10, 1791
- Марончук И. Е., см. Лубяная М. Д. 2, 364
- Мартынов В. Н., Соловьев А. Н., Шалдин Ю. В., Зерагия Э. М. Влияние примесей In и Cl на линейное электропоглощение в CdTe. 1, 168
- Мартягин В. А. Рекомбинационные свойства полупроводниковых сплавов $n\text{-V}_{1-x}\text{Sb}_x$. 12, 2223
- Марченко О. В., см. Жукова Н. М. 10, 1908
- Маслов А. И., см. Аитов Р. Д. 9, 1640
- Маслов А. П., см. Беклемишев В. И. 11, 1943
- Мастеров В. Ф., Савельев В. П., Штельмах К. Ф., Захаренков Л. Ф. Свойства сильно легированных кристаллов $\text{InP}\langle\text{Yb}\rangle$ и $\text{InP}\langle\text{Er}\rangle$. 12, 2229
- Мастеров В. Ф., см. Аскеров И. М. 7, 1305
- Мастеров В. Ф., см. Аскеров И. М. 7, 1307
- Мастеров В. Ф., см. Васильев А. Э. 5, 804
- Мастеров В. Ф., см. Байрамов Б. Х. 8, 1496
- Матвеев О. А., см. Агринская Н. В. 3, 439
- Мателешко А. В., см. Микла В. И. 1, 131
- Махамов Ш., Пахаруков Ю. В., Юнусов М. С. Влияние процесса радиационного дефектообразования на диффузионный профиль распределения алюминия в кремнии при электронном облучении. 9, 1686
- Махлин А. Н., см. Авраменко С. Ф. 3, 521
- Махонин И. И., см. Беклемишев В. И. 11, 1943
- Мадонашвили Б. Н., см. Засавицкий И. И. 11, 2019
- Машевский А. Г., см. Кузьмин И. А. 8, 1420
- Машкевич О. Л., см. Бочков А. В. 10, 1752
- Машкевич О. Л., см. Гредескул Т. С. 5, 905
- Машкевич О. Л., см. Гредескул Т. С. 10, 1895
- Машков В. А., см. Атабаев И. Г. 3, 525
- Машовец Т. В., см. Абдусаттаров А. Г. 12, 2221
- Машовец Т. В., см. Витман Р. Ф. 11, 2066
- Машовец Т. В., см. Витовский Н. А. 1, 184
- Машовец Т. В., см. Витовский Н. А. 3, 425
- Машовец Т. В., см. Витовский Н. А. 5, 911
- Медведкин Г. А., Рудь Ю. В., Таиров М. А. Фотоэффект в гетероструктурах $\text{In}_2\text{O}_3/\text{CuInSe}_2$, полученных методом термического окисления. 5, 869
- Медведкин Г. А., Рудь Ю. В., Таиров М. А. Спектры фоточувствительности структур Cu-CdSiP_2 . 6, 1002
- Медведкин Г. А., Рудь Ю. В., Таиров М. А. Анизотропия длинно-
- волнового оптического поглощения монокристаллов CuInTe_2 . 7, 1299
- Медгану Р., см. Княк С. Г. 3, 421
- Межиловская Л. И., см. Френк Д. М. 6, 1015
- Мездрогина М. М., см. Голикова О. А. 3, 450
- Мездрогина М. М., см. Голикова О. А. 10, 1737
- Мездрогина М. М., см. Регель А. Р. 9, 1552
- Мезрин О. А., см. Константинов О. В. 3, 508
- Мейлихов Е. З., см. Аронзон Б. А. 3, 471
- Мелешко Н. В., см. Курова И. А. 11, 2030
- Мельник Н. П., см. Окопечников А. П. 5, 894
- Мельничук С. В., см. Кикоин К. А. 12, 2153
- Менса С. И., см. Шмелев Г. М. 4, 712
- Меретлиев Ш. М., см. Волков А. С. 12, 2179
- Меркулов Н. А., см. Джиоев Р. И. 1, 104
- Мехтиев А. Ш., см. Гасапова А. Т. 2, 236
- Мёллман К.-П., см. Кучеренко И. В. 10, 1784
- Мигаль В. П., см. Лубышев Д. И. 10, 1913
- Мизрухин Л. В., Хируненко Л. П., Шаховцов В. И., Шинкаренко В. К., Яшник В. И. Упругие напряжения в Si с электрически пассивными примесями. 4, 704
- Мизрухин Л. В., см. Лукашевич Т. А. 5, 865
- Микитюк В. П., см. Заячук Д. М. 9, 1654
- Микла В. И., Мателешко А. В., Семак Д. Г., Левкулич А. Р. Фотостимулированная трансформация внутрислоевых состояний халькогенидных стеклообразных полупроводников. 1, 131
- Миллиевич Е. П., см. Казанский А. Г. 11, 2027
- Мильвидский М. Г., см. Бирюлин Ю. Ф. 6, 1070
- Мильвидский М. Г., см. Брук А. С. 3, 456
- Мильвидский М. Г., см. Виноградова Г. И. 7, 1177
- Миньков Г. М., см. Германенко А. В. 1, 117
- Миньков Г. М., см. Германенко А. В. 5, 796
- Миньков Г. М., см. Германенко А. В. 12, 2190
- Мирлин Д. Н., см. Алексеев М. А. 5, 761
- Мирсагатов Ш. А., см. Книгин П. И. 2, 356
- Мисюра И. В. Электропроводность и эффект Холла узкощелевых полупроводников $\text{PbSe}\langle\text{Mn}\rangle$ и $\text{Pb}_{0.78}\text{Sn}_{0.22}\text{Se}\langle\text{Mn}\rangle$. 8, 1475
- Мисюра И. В., см. Золотухина В. В. 4, 728
- Митрохин В. И., см. Лебедев А. А. 5, 897
- Михайлова Г. Н., см. Княк С. Г. 3, 421

- Михе́лашливи В. М., см. Джахута-
 швили Т. В. 12, 2198
 Михно́вич В. В., см. Арте́мьев В. А.
 8, 1395
 Михно́вич В. В., см. Витовский Н. А.
 1, 184
 Михно́вич В. В., см. Витовский Н. А.
 3, 425
 Михэ́илеску И. Н., см. Кияк С. Г.
 3, 421
 Мищук О. Н., см. Борковская О. Ю.
 2, 207
 Мищук О. Н., см. Борковская О. Ю.
 12, 2113
 Мнаца́канов Т. Т., см. Грессеров
 Б. Н. 9, 1658
 Мозо́ль П. Е., см. Вирт И. С. 8, 1386
 Мокру́шин А. Д., см. Гирка А. И.
 7, 1270
 Мокру́шин А. Д., см. Гирка А. И.
 12, 2159
 Молодцо́ва Е. В., см. Дружинина
 Л. В. 11, 2088
 Монозон Б. С., Игна́тьева Л. А.
 Многофотонное поглощение компоненты
 бихромагнитической волны в полупровод-
 нике в скрещенных электрическом и маг-
 нитном полях. 10, 1800
 Мордкóвич В. Н., см. Омелянóв-
 ская Н. М. 8, 1503
 Моро́з С. Е., см. Быковский В. А. 1, 166
 Моро́з С. Е., см. Кольченко Т. И. 3, 546
 Моро́зенко Я. В., см. Дмитриев В. А.
 1, 39
 Моро́зов А. Ф., см. Бекле́мышев В. И.
 11, 1943
 Моро́зова В. И., см. Сырбу Н. Н.
 10, 1771
 Моро́зовский А. Е., Снарский
 А. А. О гальваномагнитных явлениях
 в макроскопически неоднородных плен-
 ках вблизи порога протекания в наклон-
 ном магнитном поле. 7, 1220
 Москви́на Д. Р., Пецо́льдт Й.,
 Пота́пов Е. Н., Таи́ров Ю. М.
 Политипный фазовый переход, индуци-
 рованный ионной имплантацией. 12, 2240
 Мохов Е. Н., см. Гирка А. И. 7, 1270
 Мохов Е. Н., см. Гирка А. И. 12, 2159
 Мочало́ва Д. П., см. Курова И. А.
 3, 573
 Му́дрый А. В., см. Гельфа́нд Р. Б.
 8, 1448
 Мука́шев К. М., см. Пустовойт А. К.
 2, 257
 Муравье́в А. В., Нефе́дов И. М.,
 Ноздри́н Ю. Н., Шасти́н В. Н.
 Анизотропия валентной зоны и стимули-
 рованное излучение горячих дырок р-Ge
 в скрещенных электрическом и магнит-
 ном полях. 10, 1728
 Мусабе́ков Е., см. Бабаев А. А. 4,
 636
 Мусато́в А. Л., Гейзер С. В.,
 Коринфский А. Л. Поверхно-
 стные состояния фосфида индия, опре-
 деляющие формирование барьера Шот-
 тки. 11, 2056
 Мусато́в А. Л., Коротких В. Л.,
 Фили́ппов С. Л. Исследование поте-
 ры энергии горячими электронами в фос-
 фиде индия эмиссионным методом. 6, 994
 Мю́ллер Г. О., см. Каган В. Д. 1, 138
 Мья́кенькая Г. С., см. Гордеев В. А.
 3, 493
 Мья́кенькая Г. С., см. Гурцев Г. Л.
 6, 1042
 На́дточий М. Ю., см. Васильев А. М.
 12, 2133
 На́дточий М. Ю., см. Евтихи́ев В. П.
 5, 845
 На́дточий М. Ю., см. Копье́в П. С.
 6, 1110
 На́дточий М. Ю., см. Копье́в П. С.
 8, 1382
 Назаре́нкова Т. И., Салько́в
 Е. А., Со́чинский Н. В. Фото-
 проводимость эпитаксиальных слоев л-
 $\text{Hg}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$. 7, 1309
 Назарчу́к П. Ф., см. Берча А. И. 12,
 2244
 Назы́ров Д. Э., см. Азимов Г. К. 3, 556
 Найде́н Е. П., см. Давыдов В. Н. 9,
 1596
 На́лбандя́н Л. В., см. Витман Р. Ф.
 11, 2066
 На́лбандя́н Л. В., см. Витовский
 Н. А. 5, 911
 Намаю́нас А. М., Поже́ла Ю. К.,
 Тама́шви́чиус А. В. Численное
 моделирование микроплазменной неустой-
 чивости. 9, 1606
 Насре́динов Ф. С., см. Аскеров И. М.
 6, 1083
 Насре́динов Ф. С., см. Регель А. Р.
 9, 1552
 Натепро́в А. Н., см. Арушанов Э. К.
 1, 58
 Нау́мов А. В., Санки́н В. И. Время
 жизни неравновесных дырок в диодах
 на основе SiC. 6, 1009
 Недео́гло Д. Д., см. Тимченко И. Н.
 2, 240
 Неизве́стный И. Г., см. Белоусова
 Т. В. 11, 1955
 Неизве́стный И. Г., см. Макаров
 О. А. 6, 1038
 Не́ймарк Е. И., см. Бугэ́й А. А. 5, 872
 Не́ймаш В. Б., Си́рацкий В. М.,
 Сосни́н М. Г., Шаховцо́в В. И.,
 Шинди́ч В. Л. Влияние термодино-
 ров на радиационное дефектообразование
 в кремнии. 2, 250
 Не́йфельд Э. А., см. Горо́дилов Н. А.
 2, 316
 Не́красов В. Ю., Трухи́н В. Н.,
 Яроше́цкий И. Д. Особенности
 рассеяния коротких световых импуль-
 сов на светоиндуцированных решетках
 в кремнии. 8, 1512
 Не́красов В. Ю., см. Иванов С. В.
 9, 1564
 Не́ркара́рян Х. В. Усиление элект-
 ромагнитного излучения в экситонной
 области спектра полупроводника, 9, 1691
 Неустро́ев Л. Н., см. Кондратьева
 О. Г. 3, 536
 Неустро́ев Л. Н., см. Кондратьева
 О. Г. 10, 1741
 Нефе́дов И. М., см. Муравье́в А. В.
 10, 1728
 Ники́тенко В. Р., см. Архи́пов В. И.
 6, 978
 Ники́тин В. Г., см. Соболев М. М. 6,
 1058
 Ники́тин Л. П., см. Андре́ев В. М.
 4, 612
 Ники́форов В. Н., см. Га́йдуков
 Ю. П. 11, 2098

- Никорич А. В., см. Акимов Б. А. 4, 668
- Никорич А. В., см. Акимов Б. А. 6, 1019
- Новиков С. В., см. Воробьева В. В. 9, 1689
- Ноздрин Ю. Н., см. Муравьев А. В. 10, 1728
- Нуллер Т. А., см. Брук А. С. 3, 456
- Нурмагомедов Ш. А., Пихтин А. Н., Разбегаев В. Н., Сафаралиев Г. К., Тайров Ю. М., Цветков В. Ф. Оптическое поглощение и люминесценция твердых растворов $(\text{SiC})_{1-x}(\text{AlN})_x$. 1, 162
- Нуров К. Б., см. Глазов В. М. 10, 1834
- Овсяк В. Н., см. Бобылев Б. А. 11, - 1932
- Овчинникова Г. И., см. Девятков М. Н. 4, 751
- Огнева О. В., см. Бончик А. Ю. 10, 1893
- Огородник Я. В., см. Фреик Д. М. 6, 1015
- Одринский А. П., см. Черкасов Ю. А. 9, 1572
- Озеров Ю. П., см. Евгеньев С. Б. 8, 1347
- Омельков А. В., см. Генкин Г. М. 4, 630
- Оконечников А. П., Мельник Н. Н. Диффузионная длина дырок в селениде цинка. 5, 894
- Окулич В. И., см. Васин А. С. 3, 483
- Омельяновский Э. М., Пахомов А. В., Поляков А. Я., Бородина О. М. О диффузии водорода в кремнии. 1, 178
- Омельяновский Э. М., Пахомов А. В., Поляков А. Я., Шепкина Г. В. Пассивация акцепторных центров в фосфиде индия атомарным водородом. 7, 1267
- Омельяновский Э. М., Пахомов А. В., Поляков А. Я., Шепкина Г. В. Пассивация доноров и акцепторов в тройных и четверных растворах системы InGaAsP с помощью атомарного водорода. 9, 1711
- Омельяновский Э. М., Поляков А. Я., Тишкин М. В. Сравнение параметров глубоких центров в высокоомных полупроводниках при измерении методом фотоэлектрической релаксационной спектроскопии в вариантах температурного и частотного сканирования. 4, 725
- Омельяновский Э. М., см. Балагуров Л. А. 4, 673
- Омельяновская Н. М., Итальянцев А. Г., Краснобаев Л. Я., Мордкович В. Н., Астахова Е. Ф. Глубокие уровни в $n\text{-Si}$, вводимые при высокотемпературном газовом травлении. 8, 1503
- Орлов А. О., Савченко А. К., Шкловский Б. И. Эволюция флуктуационного потенциала при обеднении канала полевого GaAs-транзистора. 8, 1334
- Орлов В. Б., Якимов А. В. Аннотированные флуктуации подвижности носителей тока и $1/f$ -шум магнитосопротивления в полупроводниках. 8, 1341
- Орлов Л. К., Романов Ю. А. Особенности усиления электромагнитных сигналов в квантовых сверхрешетках с высоким уровнем межминизонного туннельного тока.* 3, 578
- Ормонт Н. Н., см. Курова И. А. 11, 2030
- Освенский В. Б., см. Анастасьева Н. А. 7, 1259
- Освенский В. Б., см. Марков А. В. 10, 1791
- Осипов В. В., Панкратов А. А., Холоднов В. А. Фотоэлектрическое усиление лавинных гетероструктур с тонким широкозонным слоем. 7, 1148
- Осипов В. В., Серженко Ф. Л., Шадрин В. Д. К теории внутризонного оптического поглощения в гетероструктурах с квантовыми ямами. 5, 809
- Осипов В. В., см. Ващенко В. А. 8, 1378
- Осипов В. В., см. Кондратьева О. Г. 3, 536
- Осипов В. В., см. Кондратьева О. Г. 10, 1741
- Осипов Е. Б., см. Аверкиев Н. С. 1, 73
- Осипов Е. Б., см. Аверкиев Н. С. 11, 2072
- Остриков К. Н. Дисперсионные свойства поверхностных волн на границе раздела двух полупроводников, ограниченных металлическими поверхностями.* 7, 1320
- Остробородова В. В., см. Ковалев А. Г. 11, 2039
- Осугин А. В., см. Барановский С. Д. 8, 1434
- Отман Я. И., см. Гермогенов В. П. 8, 1517
- Охонин С. А., Французов А. А. Туннельная ионизация примесных атомов фосфора в кремнии при температуре 4.2 К. 8, 1362
- Павлов П. В., см. Демидов Е. С. 3, 548
- Павлов П. В., см. Карзанов В. В. 11, 2064
- Павлов П. В., см. Лобанова Н. Е. 12, 2149
- Павловский В. Н., см. Лукашевич П. Г. 3, 578
- Павлюк С. П., см. Добровольский В. Н. 3, 416
- Падалько А. Г., см. Волков В. В. 8, 1400
- Панасюк Л. И., см. Берча А. И. 12, 2244
- Панин Г. Н., Якимов Е. Б. Изменение свойств приповерхностных слоев кристаллов $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ под воздействием электронного пучка. 8, 1351
- Панкратов А. А., см. Осипов В. В. 7, 1148
- Панов В. И., см. Антонова И. В. 2, 253
- Панов В. И., см. Антонова И. В. 6, 1076
- Панов В. И., см. Антонова И. В. 8, 1519
- Пантелеев В. А., см. Васин А. С. 3, 483
- Папаян К. З., см. Абрамян Ю. А. 8, 1486

- Папенцев М. И., см. Брунков П. Н. 9, 1689
- Парамонов В. И., см. Ковалев А. Н. 11, 2039
- Парамонов В. И., см. Колесников В. И. 6, 960
- Паранчич С. Ю., см. Гавалешко Н. Н. 6, 943
- Парманкулов И. П., см. Бахадыханов М. К. 9, 1646
- Пасекон В. Ф. Экспериментальное подтверждение модели туннельных избыточных токов в $p-n$ -переходах на антимониде индия. 3, 559
- Пастернак В. А., см. Залюбинская Л. Н. 3, 579
- Паханов М. М., см. Константинов О. В. 7, 1283
- Пахаруков Ю. В. Некоторые аспекты эффекта радиационного упорядочения. 5, 909
- Пахаруков Ю. В., см. Маххамов Ш. 9, 1686
- Пахмурская А. В., см. Бончик А. Ю. 10, 1893
- Пахомов А. А., см. Абакумов В. Н. 12, 2232
- Пахомов А. В., см. Омеляновский Э. М. 1, 178
- Пахомов А. В., см. Омеляновский Э. М. 7, 1267
- Пахомов А. В., см. Омеляновский Э. М. 9, 1711
- Пахомов А. Г., см. Иванов С. В. 9, 1564
- Пека Г. П., см. Буянов А. В. 9, 1589
- Пека Г. П., см. Коваленко В. Ф. 6, 1108
- Пенин Н. А. Умножение фотовозбужденных носителей заряда при ударной ионизации примесных атомов в полупроводниках. 3, 466
- Перель В. И., см. Карпова И. В. 5, 826
- Перлин Ю. Е., Гифейсман Ш. Н., Коропчану В. П. Межзонное смешивание и его влияние на подвижность дырок в ионных полупроводниках с вырожденной валентной зоной. 4, 734
- Перов П. И., см. Поляков В. И. 1, 125
- Першеев С. К., см. Абдурахманов К. П. 10, 1891
- Петренко В. В., см. Гринштейн П. М. 6, 1088
- Петров В. И., см. Кашкаров П. К. 11, 2080
- Петров П. П., см. Дугаев В. К. 3, 488
- Петров П. П., см. Дугаев В. К. 12, 2238
- Петров Ю. Н., см. Беклемишев В. И. 11, 1943
- Петросян Е. Г., см. Гусев В. Э. 2, 366
- Петросян С. Г., Шик А. Я. Контактные явления в двумерном электронном газе. 6, 1113
- Петрунин А. П., см. Кучинский П. В. 9, 1625
- Петухов А. Г., см. Вакаров Б. С. 7, 1182
- Пецольдт И., см. Москвина Д. Р. 12, 2240
- Пешев В. В., см. Бакин Н. Н. 5, 890
- Пирагас К., см. Бумялене С. 8, 1479
- Писаревская В. А., см. Бирюлин Ю. Ф. 6, 1070
- Пихтин А. Н., Айраксинен В.-М., Липсанен Х., Туоми Т. Наблюдение примесных состояний в высокоомном арсениде галлия методом фотоотражения. 7, 1280
- Пихтин А. Н., см. Зубков В. И. 1, 64
- Пихтин А. Н., см. Нурмагомедов Ш. А. 1, 162
- Планкина С. М., см. Карпович И. А. 12, 2164
- Плотников А. Е., см. Качурин Г. А. 3, 434
- Пляцко С. В., см. Громовой Ю. С. 6, 1025
- Погорелый В. И., см. Абрамишвили В. Г. 3, 575
- Пожела Ю. К., см. Намаюнас А. М. 9, 1606
- Показной И. И., см. Шишняну Ф. С. 12, 2218
- Половцев И. С., см. Баграев Н. Т. 6, 1098
- Половцев И. С., см. Баграев Н. Т. 9, 1643
- Полоскин Д. С., см. Витовский Н. А. 3, 425
- Полыгалов Ю. И., Басалаев Ю. М., Золотарев М. Л., Поплавной А. С. Зонная структура, плотность электронных состояний и оптические свойства $ZnSnSb_2$. 2, 279
- Полыгалов Ю. И., Поплавной А. С. Зонная структура напряженных (001) сверхрешеток $(InAs)_n(GaAs)_n$. 7, 1254
- Поляков А. Я., см. Дружинина Л. В. 11, 2088
- Поляков А. Я., см. Омеляновский Э. М. 1, 178
- Поляков А. Я., см. Омеляновский Э. М. 4, 725
- Поляков А. Я., см. Омеляновский Э. М. 7, 1267
- Поляков А. Я., см. Омеляновский Э. М. 9, 1711
- Поляков В. И., Перов П. И., Ермакова О. Н., Ермаков М. Г., Руковишников А. И., Сергеев В. И. Кинетика фототоксика и спектры Q-DLTS гетероструктур с изолирующим слоем $Al_{0.3}Ga_{0.7}As$ изготовленных МОС гибридным методом. 1, 125
- Поляновский В. М. Индуцированные магнитным полем электронные переходы в полупроводниках со сверхрешеткой. 9, 1680
- Полянская Т. А., Шмарцев Ю. В. Квантовые поправки к проводимости в полупроводниках с двумерным и трехмерным электронным газом. Эксперимент (обзор). 1, 3
- Поморцев Р. В., Заболоцкий Е. И. Энергетический спектр легких и тяжелых дырок в разбавленных магнитных полупроводниках в магнитном поле. 10, 1796
- Пономарев А. И., см. Крылов К. Р. 3, 429
- Пономаренко В. П., Салмин Е. А., Стафеев В. И., Шиманский И. В. Поверхностная подвижность электронов в МДП структурах из $Cd_xHg_{1-x}Te$ p -типа. 1, 189
- Попков А. Н., см. Дружинина Л. В. 11, 2088
- Поплавной А. С., см. Полыгалов Ю. И. 2, 279

- Поплавной А. С., см. Полюгалов Ю. И. 7, 1254
- Попов В. П., см. Качурин Г. А. 3, 434
- Попов И. В., см. Аникин М. М. 4, 647
- Попов И. В., см. Аникин М. М. 10, 1813
- Поройков Ю. А., см. Бончик А. Ю. 10, 1893
- Порошин В. Н., см. Васецкий В. М. 8, 1508
- Постолаки И. Т., см. Георгицэ Е. И. 4, 745
- Потапов Е. Н., см. Москвина Д. Р. 12, 2240
- Потапова Л. В., см. Лобанова Н. Е. 12, 2149
- Преображенский В. В., см. Лубышев Д. И. 10, 1913
- Прозоровский В. Д., Рашидова И. Ю., Тарянк Р. Н. В., Браташевский Ю. А., Диэлектрические свойства $Pb_{1-x}Sn_xSe(Cd, Zn)$. 5, 901
- Прокопенко В. Т., см. Белов Н. П. 11, 2093
- Прокофьева Л. В., см. Вейс А. Н. 7, 1230
- Прокофьева Л. В., см. Дегтярев Ю. А. 9, 1576
- Прохоров А. М., см. Княк С. Г. 3, 421
- Прохоров Е. Ф., см. Горев Н. Б. 2, 357
- Прохорович А. В., см. Глинчук К. Д. 4, 657
- Прудников И. М., см. Конорова Л. Ф. 4, 706
- Пруцких Т. А., см. Андреев В. М. 4, 597
- Птицина Н. Г., см. Воеводин Е. И. 8, 1356
- Птицын Д. В., см. Кашкаров П. К. 11, 2080
- Пуляевский Д. В., см. Абдуллаев М. А. 2, 201
- Пустовой В. И., см. Беклемышев В. И. 11, 1943
- Пустовойт А. К., Коноплева Р. Ф., Купчишин А. И., Мукашев К. М. Аннигиляция позитронов в разупорядоченных областях Ge и Si, облученных нейтронами. 2, 257
- Пушкарчук А. Л., см. Гельфанд Р. Б. 8, 1448
- Рабинович Р. И., см. Гольдгур Е. Б. 9, 1674
- Равич В. Н., см. Бончик А. Ю. 10, 1893
- Рагуотис Р. Расчет отклика электронов на высокочастотное электрическое поле в n -Si. 8, 1426
- Рагуотис Р., Сельмистрайтис Г. Исследование влияния междырочного рассеяния на время релаксации энергии дырок в Ge. 4, 709
- Раданцев В. Ф., Дерябина Т. И., Завьялов В. В., Зверев Л. П., Кмулаев Г. И., Хомутова С. С. Емкость приповерхностных слоев в кейновских полупроводниках в условиях размерного и магнитного квантования. 2, 346
- Радауцан С. И., см. Арушанов Э. К. 1, 58
- Радауцан С. И., см. Коршунов Ф. П. 9, 1581
- Радченко М. В., см. Лашкарев Г. В. 5, 874
- Разаренова Л. К., Резник И. М. Обменно-корреляционное взаимодействие и энергетические щели полупроводников.* 7, 1319
- Разбегаев В. Н., см. Кузнецов В. В. 5, 880
- Разбегаев В. Н., см. Нурмагомедов Ш. А. 1, 162
- Райчев О. Э. К вопросу о пограничных состояниях в резких гетеропереходах. 7, 1226
- Райчев О. Э., см. Грибников З. С. 12, 2171
- Раренко И. М., см. Глузман Н. Г. 6, 1032
- Растегаев В. Н., см. Аникин М. М. 4, 647
- Расулов К. Я., см. Андреев В. М. 4, 597
- Расулов Р. Я. Теория фотогальванических эффектов в кристаллах без центра инверсии простой зоны. Гармоническое приближение. 4, 698
- Рахубовский А. А. см. Блохин И. К. 10, 1747
- Рашковецкий Л. В., см. Бабенцов В. Н. 9, 1560
- Ребане Ю. Т., см. Аверкиев Н. С. 7, 1193
- Регель А. Р., Абдумананов У. Ж., Васильев В. А., Мездрогина М. М., Насрединов Ф. С., Серегин П. П. Примесные центры диспрозия в аморфном гидрогенизированном кремнии. 9, 1552
- Регель А. Р., Глазов В. М., Кольцов В. Б. Магнитная восприимчивость полупроводников в жидком состоянии (обзор). 7, 1129
- Резник И. М., см. Разаренова Л. К. 7, 1319
- Резников Б. И., Царенков Г. В. Нестационарный фотоэффект в варизонной m - p - n -структуре. I. Распространение импульса неравновесных носителей заряда. 5, 849
- Резников Б. И., Царенков Г. В. Нестационарный фотоэффект в варизонной m - p - n -структуре. II. ЭДС холостого хода. 7, 1235
- Рембеза С. И., см. Лебедев А. А. 5, 897
- Ременьк А. Д., см. Берман Л. С. 4, 753
- Решидова И. Ю., см. Прозоровский В. Д. 5, 901
- Решина И. И., см. Коньев П. С. 7, 1316
- Решиков М. А., см. Аверкиев Н. С. 1, 73
- Ржевкин К. С., см. Антов Р. Д. 9, 1640
- Ризаханов М. А., см. Зобов Е. М. 7, 1291
- Рогачев А. А., см. Андаспаева А. А. 8, 1373
- Родионов А. В., см. Кольченко Т. И. 4, 626
- Розиков Х., см. Книгин П. И. 2, 356
- Ройзин Я. О., см. Ендриховский С. А. 3, 444
- Романов В. А., см. Гасан-заде С. Г. 1, 85

- Романов В. В., см. Аскеров И. М. 7, 1305
- Романов Ю. А., см. Орлов Л. К. 3, 578
- Романычев А. И., см. Дрозд. В. Е. 11, 2085
- Руденко А. И., см. Корнеева Л. А. 5, 832
- Руденко А. И., см. Корнеева Л. А. 7, 1296
- Руденко А. И., см. Корнеева Л. А. 11, 1992
- Рудь Ю. В., см. Горячев Д. Н. 2, 312
- Рудь Ю. В., см. Константинова Н. Н. 10, 1778
- Рудь Ю. В., см. Медведкин Г. А. 5, 869
- Рудь Ю. В., см. Медведкин Г. А. 6, 1002
- Рудь Ю. В., см. Медведкин Г. А. 7, 1299
- Рузия И. М., Шкловский Б. И. Теория прыжковой фотопроводимости при длинноволновом возбуждении. 10, 1881
- Руковишников А. И., см. Поляков В. И. 1, 125
- Румянцев А. И., см. Черкасов Ю. А. 9, 1572
- Румянцев Б. Л., см. Беляков Л. В. 3, 461
- Румянцев Б. Л., см. Беляков Л. В. 11, 1966
- Румянцев В. Д., см. Андреев В. М. 4, 597
- Румянцев Е. Л., см. Германенко А. В. 1, 117
- Румянцев Е. Л., см. Германенко А. В. 5, 796
- Румянцев Е. Л., см. Германенко А. В. 12, 2190
- Румянцев С. Л., см. Дьяконова Н. В. 10, 1828
- Рут О. Э., см. Германенко А. В. 1, 117
- Рут О. Э., см. Германенко А. В. 5, 796
- Рут О. Э., см. Германенко А. В. 12, 2190
- Рухадзе З. А., см. Воронков В. П. 3, 562
- Рывкин Б. С., см. Бутусов Д. М. 9, 1601
- Рыжий В. И., см. Долманов И. Н. 3, 499
- Рыжий В. И., см. Захарова А. А. 10, 1898
- Рыжий В. И., см. Захарова А. А. 11, 1976
- Рыжих С. А., см. Крутоголов Ю. К. 5, 887
- Рыков С. А., см. Дрозд В. Е. 11, 2085
- Рябова Л. И., см. Акимов Б. А. 2, 244
- Рябова Л. И., см. Акимов Б. А. 6, 1019
- Рябченко С. М., см. Абрамишвили В. Г. 3, 575
- Сабирзянова Л. Д., см. Глузман Н. Г. 6, 1032
- Саблик В. А., см. Васильев А. Н. 1, 33
- Саблик В. А., см. Карпова И. В. 7, 1293
- Савельев В. П., см. Васильев А. Э. 11, 2069
- Савельев В. П., см. Захаренков Л. В. 8, 1515
- Савельев В. П., см. Мастеров В. Ф. 12, 2229
- Савельев И. Г., см. Воробьева В. В. 9, 1969
- Савицкий О. Г., см. Дорин В. А. 8, 1501
- Савченко А. К., см. Орлов А. О. 8, 1334
- Сагинури М. И., см. Джахуташвили Т. В. 12, 2198
- Садофьев Ю. Г., см. Белоусова Т. В. 11, 1955
- Саид Эль-Гизири, см. Кузнецов В. В. 5, 880
- Саидов М. С., см. Атабаев И. Г. 3, 525
- Салата О. В., см. Коняков С. Г. 8, 1416
- Салый Я. П., см. Фрейк Д. М. 6, 1015
- Салманов А. Р., см. Кузнецов В. И. 8, 1492
- Салмин Е. А., см. Пономаренко В. П. 1, 189
- Сальков Е. А., см. Бабенцов В. Н. 1, 174
- Сальков Е. А., см. Бабенцов В. Н. 9, 1560
- Сальков Е. А., см. Бакши И. С. 3, 571
- Сальков Е. А., см. Гасан-заде С. Г. 1, 85
- Сальков Е. А., см. Назаренкова Т. И. 7, 1309
- Сальков Т. Е., см. Голикова О. А. 11, 2060
- Самойлюкович В. А., см. Лукашевич П. Г. 3, 578
- Саморуков Б. Е., Слободчиков С. В. Влияние облучения электронами на свойства фосфида индия, легированного 3d-элементами. 5, 921
- Сангин К. В., см. Безлюдный С. В. 10, 1888
- Санкин В. И., см. Наумов А. В. 6, 1009
- Сапега В. Ф., см. Алексеев М. А. 5, 761
- Саркисян Э. С., см. Васецкий В. М. 8, 1508
- Сафаралиев Г. К., см. Нурмагомедов Ш. А. 1, 162
- Сахаров В. А., см. Алешин А. М. 6, 1116
- Сванбаев Е. А., Таурбаев Т. И. О размерах упорядоченных областей в некристаллическом гидрогенизированном кремнии. 5, 903
- Свердлов В. А., см. Ермолин А. В. 9, 1709
- Свешников Ю. Н., см. Кольченко Т. И. 4, 626
- Свирида С. В., см. Гирка А. И. 7, 1270
- Свирида С. В., см. Гирка А. И. 12, 2159
- Свиридов В. В., см. Лебедев А. А. 5, 897
- Свиридов В. Н., см. Ендриховский С. А. 3, 444
- Свистов А. Е., см. Каширская Л. М. 2, 382
- Свистов А. Е., см. Каширская Л. М. 4, 742
- Севастьянов С. Б., см. Бобылев Б. А. 11, 1932
- Седов В. Е., см. Аверкиев Н. С. 11, 2072
- Сейсян Р. П., см. Абдуллаев М. А. 2, 201
- Сейсян Р. П., см. Абдуллаев М. А. 7, 1156
- Сейсян Р. П., см. Абдуллаев М. А. 7, 1160
- Сейсян Р. П., см. Каган В. Д. 1, 138
- Селиверстов А. И., см. Берман Л. В. 11, 1959
- Сельмистрайтис Г., см. Рагуотис Р. 4, 709
- Семак Д. Г., см. Микла В. И. 1, 131
- Семиколонова Н. А., см. Богданова В. А. 10, 1900

Сеничкин А. П., см. Кадушкин В. И. 7, 1199

Сеничкин А. П., см. Кадушкин В. И. 9, 1702

Сенокосов Э. А., см. Клюканов А. А. 3, 542

Сергеев В. И., см. Поляков В. И., 1, 125

Сердега Б. К., см. Зыков В. Г. 6, 1118

Серегин П. П., см. Регель А. Р. 9, 1552

Серженко Ф. Л., см. Осипов В. В. 5, 809

Сизов В. Е., см. Балагуров Л. А. 4, 673

Сизов Ф. Ф., см. Апатская М. В. 7, 1203

Сизов Ф. Ф., см. Гавалешко Н. Н. 6, 943

Сизов Ф. Ф., см. Громовой Ю. С. 6, 1025

Симашкевич А. В., см. Горя О. С. 11, 2090

Симашкевич А. В., см. Сушкевич К. Д. 4, 737

Симашкевич А. В., см. Тимченко И. Н. 2, 240

Синицын М. А., см. Конников С. Г. 8, 1416

Синкевич В. Ф., см. Ващенко В. А. 8, 1378

Синкевич В. Ф., см. Ващенко В. А. 10, 1902

Синюков М. П., см. Макаров О. А. 6, 1038

Сипатов А. Ю., см. Колесников И. В. 6, 954

Сипатов А. Ю., см. Колесников И. В. 6, 960

Сирацкий В. М., см. Неймаш В. Б. 2, 250

Спирожов У., см. Атабаев И. Г. 3, 525

Скайстис Х. Э., см. Балтрамеюнас Р. 7, 1214

Скакун Т. А., см. Джахуташили Т. В. 12, 2198

Скипетров Е. П., см. Брандт Н. Б. 11, 2034

Скорятинна Е. А., Малкович Р. Ш. Диффузионное перераспределение марганца в GaAs. 1, 164

Скупов В. Д., Цыпкин Г. А., Шенгуров В. Г. Влияние гидростатического давления на характеристики диодов с барьерами Шоттки. 3, 554

Скуратов В. А., см. Гирка А. И. 2, 328

Слободчиков С. В., см. Саморук Б. Е. 5, 921

Смирнов В. А., см. Георгицэ Е. И. 4, 745

Смирнов Е. В., см. Шишияну Ф. С. 12, 2218

Сморгонская Э. А., см. Калмыкова Н. П. 2, 297

Смородинов С. В., см. Бакин Н. Н. 5, 890

Снарский А. А., см. Морозовский А. Е. 7, 1220

Собочкович Р. И., см. Фрейх Д. М. 6, 1015

Соболев В. В., Крамарь В. М., Козлова С. Г., Темчук Г. И. Зоны и оптические спектры селенида висмута. 8, 1430

Соболев М. М., Брунков П. Н., Конников С. Г., Степанова М. Н., Никитин В. Г., Улин В. П., Долбая А. Ш., Камушадзе Т. Д., Майсурадзе Р. М. Механизм компенсации в многослойных структурах на основе нелегированного GaAs, выращенных из раствора-расплава в Ga. 6, 1058

Соболев М. М., см. Брунков П. Н. 9, 1689

Соболев Н. А., см. Аксенов И. А. 9, 1696

Соболев Н. А., см. Воеводова А. В. 7, 1173

Соболев Н. А., см. Выжигин Ю. В. 3, 581

Соболев Н. А., см. Выжигин Ю. В. 4, 719

Соболев Н. А., см. Коршунов Ф. П. 9, 1581

Сokolова З. Н., Халфин В. Б. Расчеты вероятностей излучательных переходов и времен жизни в квантово-размерных структурах. 10, 1806

Соловьев А. Н., см. Мартынов В. Н. 1, 168

Соловьев В. А., см. Конников С. Г. 8, 1411

Соловьев В. А., см. Конников С. Г. 8, 1416

Соловьев В. Н., Хрисанов В. А. Туннельные состояния в аморфном кремнии. 1, 68

Соловьева Е. В., см. Бирюлин Ю. Ф. 6, 1070

Соловьева Е. В., см. Виноградова Г. И. 7, 1177

Соловьева Е. В., см. Виноградова Г. И. 9, 1651

Соломонов А. В., см. Зубков В. И. 1, 64

Сорокина К. Л., см. Голикова О. А. 3, 450

Сорокина К. Л., см. Голикова О. А. 10, 1737

Соснин М. Г., см. Неймаш В. Б. 2, 250

Сочинский Н. В., см. Назаренкова Т. И. 7, 1309

Средин В. Г., Укроженко В. М. Нелинейное поглощение света в Cd_{1-x}Te. 10, 1762

Сресели О. М., см. Беляков Л. В. 3, 461

Сресели О. М., см. Беляков Л. В. 11, 1966

Сталенис А., см. Балинас В. 10, 1859

Старик П. М., см. Заячук Д. М. 9, 1654

Стариков Е. В., Шикторов П. Н. Циклотронный резонанс тяжелых дырок Ge с положительными эффективными массами в условиях многолучевого стриминга в E||B полях. 3, 532

Стариков Е. В., Шикторов П. Н. Эффекты горячих дырок в односно деформированном n-Ge при E||P||[111]. 8, 1462

Старостин П. Я., см. Ломако В. М. 1, 90

Стась В. Ф., см. Бобрикова О. В. 10, 1838

Стафеев В. И., см. Пономаренко В. П. 1, 189

Стельмах В. Ф., см. Ерчак Д. П. 9, 1539

Степанов Н. П., Грабов В. М., Вольф Б. Е. Влияние межзонного перехода на затухание плазменных колебаний в сплавах висмут—сурьма. 7, 1312

Степанов Ю. А., см. Агекян В. Ф. 11, 1951

- Степанова И. В., см. Марков А. В. 10, 1791
- Степанова М. Н., см. Брунков П. Н. 9, 1689
- Степанова М. Н., см. Лебедев А. А. 5, 897
- Степанова М. Н., см. Соболев М. М. 6, 1058
- Степанцова И. В., см. Анастасьева Н. А. 7, 1259
- Степихова М. В., см. Карпович И. А. 12, 2164
- Степуренко А. А., Алиев К. М., Абакарова Н. С. Нелинейность вольтамперной характеристики монокристалла теллура в условиях электро-температурного эффекта. 9, 1584
- Стратан Г. И., см. Сырбу Н. Н. 10, 1771
- Стрельчук А. М., см. Аникин М. М. 4, 647
- Стрельчук А. М., см. Аникин М. М. 10, 1813
- Стриковский М. Д., см. Калягин М. А. 6, 964
- Строганов Д. Р., см. Кузьмин И. А. 8, 1420
- Строкан Н. Б., см. Андреев В. М. 3, 478
- Строкан Н. Б., см. Еремин В. К. 9, 1613
- Стук А. А., см. Воеводова А. В. 7, 1173
- Стук А. А., см. Гринштейн П. М. 6, 1088
- Стусь Н. М., см. Айдаралиев М. 4, 592
- Стучинский В. А., см. Болотов В. В. 7, 1142
- Стыс Л. Е. Модель аномальной фотопроводимости. 2, 378
- Стыс Л. Е. Механизм туннельной термостимулированной релаксации тока. 11, 1971
- Субашиев А. В., см. Герчиков Л. Г. 12, 2210
- Судейменов Т., см. Глазов В. М. 1, 187
- Судейменов Т., см. Глазов В. М. 8, 1469
- Султанмуратов С., см. Абасова А. З. 1, 152
- Супрун С. П., см. Белоусова Т. В. 11, 1955
- Супрун С. П., см. Макаров О. А. 6, 1038
- Суриков И. Н., см. Безлюдный С. В. 10, 1888
- Сущкевич К. Д., Симашкевич А. В., Коваль А. В. Изменение ансамбля центров излучательной рекомбинации в селениде цинка под влиянием термообработки. 4, 737
- Сушко Б. И., см. Алешин А. М. 6, 1116
- Сырбу Н. Н., Морозова В. И., Стратан Г. И. Тонкая структура спектров связанного экситона в тетрагональном дифосфиде цинка. 10, 1771
- Сыркин А. Л., см. Аникин М. М. 4, 647
- Сыркин А. Л., см. Аникин М. М. 10, 1813
- Сыровегин С. М., см. Карпова И. В. 5, 826
- Сыродоев Г. А., см. Крючков С. В. 5, 857
- Тагиев А. Г., см. Гасанова А. Т. 2, 236
- Тагиев Б. Г., см. Аскеров И. М. 6, 1083
- Тагиев О. Б., см. Аскеров И. М. 7, 1307
- Тагирджанов М. А., см. Колобов А. В. 4, 601
- Таиров М. А., см. Горячев Д. Н. 2, 342
- Таиров М. А., см. Медведкин Г. А. 5, 869
- Таиров М. А., см. Медведкин Г. А. 6, 1002
- Таиров М. А., см. Медведкин Г. А. 7, 1299
- Таиров Ю. М., см. Москвина Д. Р. 12, 2240
- Таиров Ю. М., см. Нурмагомедов Ш. А. 1, 162
- Тамашевичюс А. В., см. Намаюнас А. М. 9, 1606
- Тананаева О. И., см. Акимов Б. А. 2, 244
- Таптыгов Э. С., см. Витман Р. Ф. 5, 919
- Тарасик М. И., Шварков Д. С., Янченко А. М. Пьезо-холл-эффект в р-кремнии. 6, 1080
- Таряник Н. В., см. Прозоровский В. Д. 5, 901
- Таурбаев Т. И., см. Сванбаев Е. А. 5, 903
- Теленков С. А., см. Гусев В. Э. 2, 366
- Темчук Г. И., см. Соболев В. В. 8, 1430
- Терентьев А. И., см. Агринская Н. В. 2, 231
- Терентьев А. И., см. Агринская Н. В. 3, 439
- Терехов В. А., Кашкаров В. М., Домашевская Э. П., Арсенцев Н. Н., Иванова Т. М. Электронное строение валентной зоны твердых растворов $Al_yGa_{1-y}As$ и $GaAs_{1-x}P_x$ по данным рентгеновской спектроскопии. 2, 268
- Терехов В. А., см. Голикова О. А. 3, 450
- Теруков Е. И., см. Бабаев А. А., 4, 636
- Тесленко Г. И., см. Малютенко В. К. 8, 1452
- Тетельбаум Д. И., см. Лобанова Н. Е. 12, 2149
- Тетеркин В. В., Белоконов С. А. Резонансные состояния в монокристаллах $PbTe:Ti$, выращенных методом Чохральского. 11, 2096
- Тетеркин В. В., см. Апатская М. В. 7, 1203.
- Тешабаев А. Т., см. Абдурахманов К. П. 7, 1301
- Тигиняну И. М. Об одном механизме образования квазинепрерывно распределенных по энергии ловушек в кристаллах полупроводников и диэлектриков. 9, 1568
- Тигиняну И. М., Урсаки В. В., Фулга В. Н. О фазовом переходе порядок—беспорядок в катионной под решетке соединения $ZnGa_2Se_4$. 10, 1725
- Тигиняну И. М., см. Коршунов Ф. П. 9, 1581
- Тийс С. А., см. Качурин Г. А. 3, 434
- Тимошенко В. Ю., см. Кашкаров П. К. 11, 2080
- Тимченко И. Н., Касиян В. А., Недеогло Д. Д., Симашкевич А. В. Прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка в кристаллах n - $ZnSe$ в умеренно сильных электрических полях. 2, 240
- Тимченко И. Н., см. Баранов А. Н. 5, 780
- Титов А. И., см. Аброян И. А. 5, 892
- Тихов С. В., Касаткин А. П., Карпович С. И., Кудрявцева

- Н. В. Влияние анодного окисления на глубокие уровни в арсениде галлия. 9, 1694
- Тишкин М. В., см. Дружинина Л. В. 11, 1088
- Тишкин М. В., см. Омеляновский Э. М. 4, 725
- Ткаченко В. Н., см. Берман Л. С. 4, 753
- Ткаченко В. Н., см. Берман Л. С. 12, 2129
- Ткаченко В. Н., см. Буянов А. В. 9, 1589
- Ткаченко Е. А., см. Караваев Г. Ф. 11, 1938
- Токалин О. А., см. Буянов А. В. 9, 1589
- Токалин О. А., см. Коваленко В. Ф. 6, 1108
- Толпыго К. Б., Штаерман Э. Я. Влияние заряженных AD^+ -комплексов на спектр краевой люминесценции. 6, 1121
- Толстихин В. И., Долманов И. Н. Нелинейно-оптические явления в волноводной $P-i-N$ ДГС при эффекте Франца—Келдыша. 11, 1997
- Толстихин В. И., см. Долманов И. Н. 3, 499
- Толстобров М. Г., см. Берман Л. С. 4, 753
- Томчук П. М., см. Лев Б. И. 9, 1529
- Топоров В. В., см. Байрамов Б. Х. 8, 1496
- Торчинская Т. В., см. Лев Б. И. 9, 1529
- Тофан В. А., см. Канцер В. Г. 11, 2006
- Третьяк О. В., см. Белокурова И. Н. 10, 1869
- Трипачко Н. А., см. Грехов А. М. 4, 746
- Тростянский С. Н., см. Голикова О. А. 3, 450
- Трофимов В. Т., см. Засавицкий И. И. 11, 2019
- Трошков С. И., см. Константинов О. В. 3, 508
- Трухин В. Н., см. Иванов С. В. 9, 1564
- Трухин В. Н., см. Некрасов В. Ю. 8, 1512
- Туома Т., см. Пихтин А. Н. 7, 1280
- Тураев А. Р., см. Зайнабидинов С. З. 12, 2118
- Тысченко И. Е., см. Качурин Г. А. 3, 434
- Тюкин В. Ю., см. Ершова Т. П. 2, 323
- Тютерева В. Г., см. Гриняев С. Н. 8, 1458
- Уйманов Е. В., см. Караваев Г. Ф. 11, 1938
- Уколов А. Т., см. Горев Н. Б. 2, 357
- Укроженко В. М., см. Средин В. Г. 10, 1762
- Улин В. П., см. Соболев М. М. 6, 1058
- Ульяшин А. Г., см. Гельфанд Р. Б. 8, 1448
- Уманский В. Е., см. Конников С. Г. 8, 1411
- Уманский В. Е., см. Конников С. Г. 8, 1416
- Умаров Т. А., см. Абдурахманов К. П. 7, 1301
- Унтила П. Г., см. Георгице Е. И. 4, 745
- Урсаки В. В., см. Горшунов Ф. П. 9, 1581
- Урсаки В. В., см. Тигиняну И. М. 10, 1725
- Урсу И., см. Княк С. Г. 3, 421
- Усик В. П., см. Бобылев Б. А. 11, 1932
- Устинов В. М., см. Андреев В. М. 4, 612
- Устинов В. М., см. Васильев А. М. 12, 2133
- Устинов В. М., см. Евтихийев В. П. 5, 845
- Устинов В. М., см. Кошнев П. С. 6, 1110
- Устинов В. М., см. Кошнев П. С. 8, 1382
- Утамурадова Ш. Б., см. Лебедев А. А. 12, 2227
- Утенко В. И., см. Быковский В. А. 1, 79
- Утенко В. И., см. Быковский В. А. 10, 1767
- Уфимцев В. Б., см. Евгеньев С. В. 8, 1347
- Ушакина Н. Н., см. Апатская М. В. 7, 1203
- Фадеева А. П., см. Ибрагимова М. И. 7, 1249
- Федина Л. И., см. Асеев А. Л. 1, 171
- Федирко В. А., см. Вьюрков В. В. 9, 1713
- Федоренко А. И., см. Колесников И. В. 6, 960
- Федоров В. В., см. Гринштейн П. М. 6, 1088
- Федоров В. М., см. Клюканов А. А. 3, 542
- Федорова О. М., см. Кузьмин И. А. 8, 1420
- Федосов А. В., см. Берча А. И. 12, 2244
- Филаретова Г. М., см. Андаспаева А. А. 8, 1373
- Филипов И. М., см. Казакевич Л. А. 4, 722
- Филипов И. М., см. Казакевич Л. А. 4, 748
- Филипов С. Л., см. Мусатов А. Л. 6, 994
- Фистуль В. И., Шмугуров В. А. Межузельные состояния примесей переходных металлов в кремнии. I. Теория миграции. 4, 677
- Фистуль В. И., Шмугуров В. А. Межузельные состояния примесей переходных металлов в кремнии. II. Теория миграции, сравнение с экспериментом. 4, 684
- Фистуль В. И., Шмугуров В. А. Межузельные состояния примесей переходных металлов в кремнии. III. Теория растворимости. 4, 688
- Фистуль В. И., см. Берман Л. С. 11, 1947
- Фистуль В. И., см. Зайнабидинов С. З. 12, 2118
- Фоломин П. И., см. Ковалев А. Н. 6, 968
- Фоломин П. И., см. Ковалев А. Н. 11, 2039
- Французов А. А., см. Охонин С. А. 8, 1362
- Фрасуняк В. М., см. Германенко А. В. 1, 177
- Фреик Д. М., Салий Я. П., Межиловская Л. И., Собкович

- Р. И., Школьный А. К., Огородник Я. В. Образование радиационных дефектов в пленках PbSe при облучении α -частицами. 6, 1015
- Фулга В. Н., см. Тигиняну И. М. 10, 1725
- Хайбуллин И. Б., см. Ибрагимова М. И. 7, 1249
- Халлер Ю. Э., см. Гельмонт Б. Л. 8, 1440
- Халфин В. Б., см. Соколова З. Н. 10, 1806
- Ханнебергер Ф., см. Балтрамеюнас Р. 5, 792
- Хансваров Р. Ю., см. Безлюдный С. В. 10, 1888
- Харченко В. А., см. Гринштейн П. М. 6, 1088
- Хвостиков В. П., см. Андреев В. М. 4, 597
- Хиврич В. И., см. Гроза А. А. 6, 975
- Хижняк Б. И., см. Бакши И. С. 3, 571
- Химичев А. И., см. Коваленко В. Ф. 6, 1108
- Хируненко Л. И., см. Мизрухин Л. В. 4, 704
- Хлебов А. Г., см. Вывенко О. Ф. 8, 1521
- Ходжаев К. Х., см. Абдурахманов К. П. 10, 1891
- Ходжаев М. Д., см. Абдурахманов К. П. 7, 1301
- Ходжаев М. Д., см. Зайнабидинов С. З. 12, 2118
- Холоднов В. А., см. Блохин И. К. 10, 1747
- Холоднов В. А., см. Осипов В. В. 7, 1148
- Хомутова С. С., см. Раданцев В. Ф. 2, 346
- Хомяк В. В., см. Крылов К. Р. 3, 429
- Хорош А. Г., см. Брандт Н. Б. 11, 2034
- Хохлов Д. Р., см. Акимов Б. А. 4, 668
- Хохлов Д. Р., см. Акимов Б. А. 5, 899
- Хрисанов В. А., см. Соловьев В. Н. 1, 68
- Царенков Б. В., см. Волков А. С. 12, 2179
- Царенков Б. В., см. Дмитриев В. А. 1, 39
- Царенков Г. В., см. Резников Б. И. 5, 849
- Царенков Г. В., см. Резников Б. И. 7, 1235
- Цацульников А. Ф., см. Аверкиев Н. С. 11, 2072
- Цветков В. Ф., см. Нурмагомедов Ш. А. 1, 162
- Цидильковский И. М., см. Крылов К. Р. 3, 429
- Цикунов А. В., см. Кузнецов В. И. 8, 1492
- Ципер Е. В., см. Дрозд В. Е. 11, 2085
- Цисовски Ян, см. Лашкул А. В. 8, 1406
- Цыбеков Л. В., см. Ендриховский С. А. 3, 444
- Цыпкин Г. А., см. Скупов В. Д. 3, 554
- Цэндин К. Д., см. Калмыкова Н. П. 2, 297
- Цюцюра Д. И., см. Андрухив М. Г. 7, 1263
- Чайковский И. А., см. Шмелев Г. М. 4, 712
- Чалдышев В. В., Якушева Н. А. Амфотерные свойства германия в GaAs: Bi. 1, 44
- Чалдышев В. В., Якушева Н. А. Люминесценция глубоких уровней в l-GaAs: Ge, Bi. 2, 224
- Чалдышев В. В., см. Анастасьева Н. А. 7, 1259
- Чалдышев В. В., см. Бирюлин Ю. Ф. 6, 1070
- Чалдышев В. В., см. Гермогенов В. П. 8, 1517
- Чалдышев В. В., см. Лубышев Д. И. 10, 1913
- Чебан В. В., см. Шиняну Ф. С. 12, 2218
- Челноков В. Е., см. Дмитриев В. А. 1, 39
- Черенков А. Е., см. Дмитриев В. А. 1, 39
- Черкасов Ю. А., Буров П. А., Давыдов И. А., Лучина В. Г., Одринский А. П., Румянцев А. И. Исследование центров фоточувствительности в инжекционных слоях CdSe. 9, 1572
- Чесноков С. Н., см. Акимов Б. А. 4, 668
- Чесноков С. Н., см. Акимов Б. А. 5, 899
- Чиловани Р. П., см. Джахуаташвили Т. В. 12, 2198
- Чирков Е. Г., см. Дружинин Ю. П. 4, 756
- Чистяков В. М., см. Конников С. Г. 8, 1411
- Чугуева З. И., см. Баранов А. Н. 5, 780
- Чудинов С. М., см. Абрамов В. В. 9, 1704
- Шадрин В. Д., см. Осипов В. В. 5, 809
- Шадрин В. С., см. Кочетов Ю. А. 10, 1904
- Шаймеев С. С., Антонова И. В. Механизм взаимодействия атомов золота с донорной примесью в кремнии. 8, 1367
- Шаймеев С. С., см. Антонова И. В. 2, 253
- Шаймеев С. С., см. Антонова И. В. 6, 1076
- Шаймеев С. С., см. Антонова И. В. 8, 1519
- Шалдин Ю. В., см. Мартынов В. Н. 1, 168
- Шастиг В. Н., см. Муравьев А. В. 10, 1728
- Шаховцов В. И., Шаховцова С. И., Шварц М. М., Шпинар Л. И., Ясковец И. И. Подвижность носителей тока в твердых растворах $Ge_{1-x}Si_x$. 1, 48
- Шаховцов В. И., Ясковец И. И. Эффективность аннигиляции компонентов пар Френкеля на атомах кислорода в Si. 5, 914
- Шаховцов В. И., см. Грехов А. М. 4, 746
- Шаховцов В. И., см. Мизрухин Л. В. 4, 704
- Шаховцов В. И., см. Неймаш В. Б. 2, 250
- Шаховцова С. И., см. Белокурова И. Н. 10, 1869

- Шаховцова С. И., см. Шаховцов В. И. 1, 48
- Шашкова В. В., см. Агринская Н. В. 3, 439
- Шварков Д. С., см. Тарасик М. И. 6, 1080
- Шварц К. К., см. Шунин Ю. Н. 6, 1049
- Шварц М. М., см. Белокурова И. Н. 10, 1869
- Шварц М. М., см. Шаховцов В. И. 4, 48
- Шевченко Н. В., см. Баранский П. П. 3, 579
- Шейнкман М. К., см. Абакумов В. Н. 12, 2232
- Шейнкман М. К., см. Лев Б. И. 9, 1529
- Шелонин Е. А., см. Яковенко А. Г. 8, 1390
- Шелушигина Н. Г., см. Городилов Н. А. 2, 316
- Шелых А. И., см. Жузе В. П. 3, 393
- Шемякова Т. Д., см. Арушанов Э. К. 1, 58
- Шенгуров В. Г., см. Скупов В. Д. 3, 554
- Шепкина Г. В., см. Омеляновский Э. М. 7, 1267
- Шепкина Г. В., см. Омеляновский Э. М. 9, 1711
- Шепельский Г. А., см. Гасан-заде С. Г. 1, 85
- Шерстнев В. В., см. Баранов А. Н. 5, 780
- Шерстяков А. П., см. Воронин С. Т. 5, 787
- Шерстякова В. Н., см. Белоусова Т. В. 11, 1955
- Шик А. Я., см. Петросян С. Г. 6, 1113
- Шикторов П. Н., см. Стариков Е. В. 3, 532
- Шикторов П. Н., см. Стариков Е. В. 8, 1462
- Шилова М. В., см. Карпович И. А. 12, 2164
- Шиманский И. В., см. Пономаренко В. П. 1, 189
- Шиндич В. Л., см. Нейман В. Б. 2, 250
- Шинкаренко В. К., см. Мизрухин Л. В. 4, 704
- Широкова Н. А., см. Акимов Б. А. 2, 244
- Широкова Н. А., см. Акимов Б. А. 6, 1019
- Шишняну Ф. С., Показной И. И., Смирнов Е. В., Чебан В. В., Шонта В. П. Численный расчет профилей радиационно-стимулированной диффузии примесей для случая быстрого термического отжига. 12, 2218
- Шинкин А. В., см. Гирка А. И. 2, 328
- Шинкин А. В., см. Гирка А. И. 7, 1270
- Шинкин А. В., см. Гирка А. И. 12, 2159
- Шкловский Б. И., см. Аладашвили Д. И. 2, 213
- Шкловский Б. И., см. Барановский С. Д. 1, 146
- Шкловский Б. И., см. Барановский С. Д. 1, 192
- Шкловский Б. И., см. Орлов А. О. 8, 1334
- Шкловский Б. И., см. Рузин И. М. 10, 1881
- Школьный А. К., см. Фреик Д. М. 6, 1015
- Шкорбатов А. Г., см. Богачек Э. Н. 12, 2234
- Шкумбатьюк П. С., см. Андрухив М. Г. 7, 1263
- Шленский А. А., см. Брук А. С. 3, 456
- Шленский А. Л., см. Дружинина Л. В. 11, 2038
- Шлыгин П. Н., см. Кюрегян А. С. 7, 1164
- Шмарцев Ю. В., см. Анастасьева Н. А. 7, 1259
- Шмарцев Ю. В., см. Бирюлин Ю. Ф. 6, 1070
- Шмарцев Ю. В., см. Гермогенов В. П. 8, 1517
- Шмарцев Ю. В., см. Лубышев Д. И. 10, 1913
- Шмарцев Ю. В., см. Полянская Т. А. 1, 3
- Шматов А. А., см. Белокурова И. Н. 10, 1869
- Шмелев Г. М., Чайковский И. А., Менса С. И. Термоэлектрические свойства сверхрешеток во внешних полях. 4, 712
- Шмелев Г. М., см. Железняк Т. А. 2, 376
- Шмид В., см. Выжигин Ю. В. 4, 719
- Шмургулов В. А., см. Фистуль В. И. 4, 677
- Шмургулов В. А., см. Фистуль В. И. 4, 684
- Шмургулов В. А., см. Фистуль В. И. 4, 688
- Шокина Е. В., см. Еремин В. К. 9, 1613
- Шонта В. П., см. Шиншняну Ф. С. 12, 2218
- Шпинар Л. И., см. Шаховцов В. И. 1, 48
- Штаерман Э. Я., см. Толпыго К. Б. 6, 1121
- Штанов А. А., см. Арушанов Э. К. 1, 58
- Штельмах К. Ф., см. Аскеров И. М. 7, 1305
- Штельмах К. Ф., см. Аскеров И. М. 7, 1307
- Штельмах К. Ф., см. Мастеров В. Ф. 12, 2229
- Штепгель К. Э., см. Абдуллаев М. А. 2, 201
- Штрапенин Г. Л., см. Давыдов А. Б. 4, 715
- Шуман В. Б., см. Зубрилов А. С. 4, 607
- Шумский В. Н., см. Белоусова Т. В. 11, 1955
- Шумский В. Н., см. Макаров О. А. 6, 1038
- Шунин Ю. Н., Шварц К. К. Влияние состава на электронную структуру аморфного $As_{20}Se_{80-x}$. 6, 1049
- Шуптар Д. Д., см. Андрухив М. Г. 7, 1263
- Шуша В. В., см. Колковский И. И. 5, 885
- Щамалова Б. С., см. Байрамов М. А. 9, 1618
- Энтин М. В. Теория когерентного фотогальванического эффекта. 6, 1066
- Элбакян В. Л., см. Арутюнян В. М. 3, 505
- Югова Т. Г., см. Брук А. С. 3, 456
- Юнович А. Э., см. Колесников И. В. 6, 960
- Юнусов М. С., см. Махамов Ш. 9, 1686
- Юрков С. Н., см. Кюрегян А. С. 10, 1819

- Юрова Е. С., см. Гринштейн П. М. 6, 1088
- Юрченко В. Б., см. Туревич Ю. Г. 4, 643
- Юрчук С. Ю., см. Кольцов Г. И. 7, 1320
- Юрчук С. Ю., см. Кольцов Г. И. 10, 1906
- Юршенас С., см. Балтрамеюнас Р. 3, 565
- Юсупов А., см. Атабаев И. Г. 3, 525
- Юцис А. И., см. Лубяная М. Д. 2, 364
- Явич Б. С., см. Кузьмин И. А. 8, 1420
- Якименко А. Н., см. Безлюдный С. В. 10, 1888
- Якименко А. Н., см. Безлюдный С. В. 11, 2013
- Якимов А. В., см. Орлов В. Б. 8, 1341
- Якимов Е. Б., см. Панин Г. Н. 8, 1351
- Якобсон М. А., см. Каган В. Д. 1, 138
- Яковенко А. Г., Шелонин Е. А.
Поведение меди в процессе распада ее пересыщенного твердого раствора в германии. 8, 1390
- Яковлев Ю. П., см. Андаспаева А. А. 8, 1373
- Яковлев Ю. П., см. Баранов А. Н. 5, 780
- Якунин М. В., Арапов Ю. Г. Резонансы гальваномагнитных эффектов в $Hg_{1-x}Cd_xTe$ в сильных электрических полях. 12, 2203
- Якушева Н. А., см. Чалдышев В. В. 1, 44
- Якушева Н. А., см. Чалдышев В. В. 2, 221
- Янченко А. М., см. Тарасик М. И. 6, 1080
- Ярославцев Н. П., см. Лебедев А. А. 5, 897
- Ярошецкий И. Д., см. Беляков Л. В. 3, 461
- Ярошецкий И. Д., см. Беляков Л. В. 11, 1966
- Ярошецкий И. Д., см. Берегулин Е. В. 6, 947
- Ярошецкий И. Д., см. Иванов С. В. 9, 1564
- Ярошецкий И. Д., см. Некрасов В. Ю. 8, 1512
- Ясковец И. И., см. Шаховцов В. И. 1, 48
- Ясковец И. И., см. Шаховцов В. И. 5, 914
- Яссьевич И. Н., см. Абакумов В. Н. 12, 2232
- Яськов А. Д., см. Белов Н. П. 11, 2093
- Ятлинко И. И., см. Исаев А. И. 1, 181
- Яшник В. И., см. Минзрухин Л. В. 4, 704